

智慧財產及商業法院刑事判決

111年度刑智上重更一字第1號

上訴人 臺灣臺中地方檢察署檢察官

上訴人

即被告 何建廷

選任辯護人 賈俊益律師

上訴人

即被告 王永銘

選任辯護人 王永春律師

謝佩軒律師

上訴人

即被告 戎樂天

選任辯護人 賴淑芬律師

蔡菁華律師

陳明律師

上列上訴人等因被告等違反營業秘密法等案件，不服臺灣臺中地方法院106年度智訴字第 11號，中華民國109年6月12日第一審判決（起訴案號：臺灣臺中地方檢察署106年度偵字第4520、5612、5613、11035號），提起上訴，判決後經最高法院第一次發回更審，本院判決如下：

主 文

原判決關於何建廷、王永銘、戎樂天部分撤銷。

何建廷犯如附表一編號1所示之罪，處如附表一編號1所示之刑及沒收。

件所示，下稱本案資訊），並未將該等資訊對外公開，非一般公眾或同業所得知悉，又該等資訊如遭競爭同業取得，將可能導致美國美光公司競爭優勢之削減，具高度經濟價值，復將該等資訊以電磁紀錄方式保存在具有加密及管制存取功能之電腦伺服器，臺灣美光公司員工登入電腦伺服器存取電磁紀錄時，需輸入帳號及密碼，且自105年4月20日起，即不得使用連接電腦與外部儲存設備之一種端口(USB PORT)進行存取等管制措施，而已採取合理之保密措施，是本案資訊為營業秘密法第2條之營業秘密。

二、何建廷於103年2月24日在臺灣美光公司任職時，曾簽訂聘僱合約及保密暨智慧財產合約，約定何建廷與臺灣美光公司之僱傭關係終止時，何建廷應將斯時擁有或掌握之機密資訊（包含營業秘密）文件、紀錄、筆記本或其他可存放機密資訊之物品留予公司，包括其複本與紙本及電子方式保存之資訊。倘何建廷在非臺灣美光公司之財產上存有機密資訊，應將此等機密資訊返還，並銷毀其擁有或掌握之複本。何建廷因擔任臺灣美光公司之量產整合部課長職務，其於任職期間，使用臺灣美光公司之電腦系統，自臺灣美光公司及美國美光公司之伺服器，讀取屬於美國美光公司DRAM製程之A電磁紀錄（詳如附件一（一）所示，業經檢察官更正如附件一（一）），並下載重製至己所有之行動硬碟（即附表三編號25）及隨身碟（即附表三編號35），且持有美國美光公司營業秘密之B紙本資料（詳如附件一（二）所示，業經檢察官更正如附件一（二）所示；即附表三編號34、36）。何建廷雖於104年10月15日自臺灣美光公司離職，惟未依照上開合約內容，刪除或銷毀所持有之A電磁紀錄及B紙本資料，並於104年11月5日至聯華電子股份有限公司（United Microelectronics Corp., UMC，下稱聯電公司）任職，嗣於105年4月間，擔任聯電公司新事業發展中心(New Business Development, NBD)專案技術二處(PM2)部門下之製程整合一部(PI1)經理。何建廷在聯電公司任職期間，竟意圖為自己不法之利益及損害美國美光公

司之利益，基於持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀及持有營業秘密，逾越授權範圍而使用該營業秘密之犯意，其於104年10月15日自臺灣美光公司離職後，迄106年2月7日為法務部調查局新北市調查處（下稱新北市調查處）執行搜索前之期間，不為刪除或銷毀A電磁紀錄及B紙本資料，進而逾越臺灣美光公司原授權使用該等資訊之範圍，而於104年11月5日至聯電公司任職起，迄新北市調查處於106年2月7日為執行搜索前之某日，在○○市○○區○○○路0號000室即聯電公司宿舍、○○市○○區○○○路00號之聯電公司0000廠第二廠區PM2辦公室，以聯電公司所配發，並已解除USB PORT管制之筆記型電腦（即附表三編號37），讀取使用A電磁紀錄（鑑驗後另儲存於附表三編號38所示硬碟），並將如附件一（一）編號1916所示電磁紀錄，重製在上開筆記型電腦內，且將B紙本資料攜帶至聯電公司辦公室內供己閱覽使用。

三、王永銘原在臺灣美光公司擔任製程整合部副理，曾於103年2月26日與臺灣美光公司簽訂聘僱合約及保密暨智慧財產合約，嗣於105年1月15日調任品質工程部副理，權限雖可查詢臺灣美光公司所有成品相關資料，以確認DRAM晶圓產品符合客戶要求之規格及品質，然無權限重製或下載C電磁紀錄（詳如附件二（一）所示）及D紙本資料（詳如附件二（二）所示）。其任職時曾簽署聘僱合約與保密暨智慧財產合約，明知其業務上所知悉、持有之電磁紀錄等與研發DRAM有關之技術、製程、設計等資訊，均係美國美光公司所有營業秘密，未經授權或非為執行職務需要，不得傳輸、攜出、列印、傳真或用其他方式散布、重製、使用或洩漏美國美光公司之營業秘密。詎王永銘於105年4月5日向臺灣美光公司提出辭職申請，經臺灣美光公司同意後，嗣於105年4月26日離職，並簽署離職聲明，而為下列犯行：

（一）王永銘竟意圖為自己不法之利益及損害美國美光公司之利益，基於擅自重製營業秘密及無故取得他人電磁紀錄之犯

01 意，利用任職臺灣美光公司之期間，自105年 4月16日起至
02 同年4月23日止之某日，使用臺灣美光公司所配發之筆記型
03 電腦(即附表三編號1)，自臺灣美光公司及美國美光公司之
04 伺服器，讀取屬於美國美光公司DRAM製程等營業秘密之C電
05 磁紀錄(業據檢察官更正如附件二(一)所示)，並非法下載重
06 製至臺灣美光公司所有，而由其所使用之筆記型電腦(即附
07 表三編號1，鑑驗後另儲存於附表三編號38所示硬碟)後，
08 自105年4月16日起至同年 4月23日止，接續擅自將C電磁紀
09 錄非法重製至己所有之隨身碟(即附表三編號3)，繼而以
10 隨身碟轉存備份C電磁紀錄至己所有之COMPAQ筆記型電腦(即
11 附表三編號2，重製範圍如附表二編號1所示)及ACER筆記型
12 電腦(即附表三編號6，重製範圍如附表二編號2所示)，並上
13 傳至Google Drive網路雲端硬碟(帳號0000000000000000.co
14 m，重製範圍如附表二編號 3所示，另儲存於附表三編號2
15 4)，而非法取得美國美光公司、臺灣美光公司上開營業秘
16 密之電磁紀錄，致生損害於美國美光公司、臺灣美光公司對
17 於電磁紀錄保存之完整性與隱密性。

18 (二)王永銘於105年4月28日至聯電公司新事業發展中心專案技術
19 二處(PM2)擔任元件部(Device)技術經理後，詎基於意圖為
20 自己不法之利益及損害美國美光公司利益，接續擅自重製營
21 業秘密，並進而使用營業秘密之犯意，在聯電公司任職期
22 間，以己所有之行動電話(即附表三編號16)及聯電公司所配
23 發之筆記型電腦(即附表三編號19)，連接網路直接讀取上開
24 Google Drive網路雲端硬碟所儲存之電磁紀錄，復接續以行
25 動電話(即附表三編號16)、筆記型電腦(即附表三編號19)、
26 隨身硬碟(即附表三編號5)、隨身碟(即附表三編號20)分
27 別下載備份如附表二編號4至7所示電磁紀錄(重製範圍如附
28 表二編號4至7所示)，並下載臺灣美光公司所使用之「DRAM
29 設計規則」電磁紀錄(檔名「【DR25nmS】Temporary desig
30 n rules Periphery Rev.06」，下稱 DR25nmS設計規則)及
31 其他電磁紀錄，接著列印成 D紙本資料(業經檢察官更正如

01 附件二(二)所示，即附表三編號9、22)，而擅自非法重製
02 美國美光公司之營業秘密，繼而在聯電公司辦公室、宿舍等
03 處供己閱覽使用該等營業秘密。

04 四、臺灣美光公司於王永銘離職後，經清查後發現王永銘擅自重
05 製 C 電磁紀錄，美國美光公司、臺灣美光公司為此向新北市
06 調查處提出告訴，並提出如附表三編號 1 所示之筆記型電腦
07 供扣押。嗣新北市調查處調查官於106年2月7日，持搜索票
08 ，前往○○市○○區○○巷00號、○○市○○區○○○○路
09 0段000號00樓之0、○○市○○區○○○○路000號與000號0至
10 0樓、○○市○○區○○○○路00號及其相通連之處所(王永銘
11 位於聯電公司000000第二廠區之產品經理辦公室)等處執行
12 搜索，並扣得附表三編號 2至19所示之物品。且臺灣臺中地
13 方檢察署檢察官前於106年 2月8日訊問何建廷時，開庭後何
14 建廷主動提出如附表三編號25所示之行動硬碟供扣押；另於
15 106年2月 9日扣得如附表三編號20至23所示物品。新北市調
16 查處調查官另於106年2月14日持搜索票，至○○市○○區○
17 ○○○路00號聯電公司000000第二廠區之新事業發展中心之專
18 案技術二處PM2之何建廷個人辦公室執行搜索，並扣得如附
19 表三編號26至33所示物品，始查悉上情。

20 五、案經臺灣美光公司、美國美光公司訴由新北市調查處移送臺
21 灣臺中地方檢察署檢察官偵查起訴。

22 理 由

23 甲、有罪部分：

24 壹、程序部分：

25 一、本件審理範圍：

26 (一)檢察官起訴上訴人即何建廷、王永銘等人違反營業秘密法等
27 案件，經原審判決後，檢察官及何建廷、王永銘、戎樂天等
28 人均不服提起上訴，本院前審審理後，以 109年度刑智上重
29 訴字第 4號刑事判決就被告何建廷部分，撤銷其涉犯營業秘
30 密法第13條之2之罪部分，改量處營業秘密法第13條之1之罪
31 及罪刑，另就所涉營業秘密法第13條之2改判不另為無罪諭

01 知；就被告王永銘部分，撤銷其涉犯營業秘密法第13條之2
02 之罪部分，改量處營業秘密法第13條之1、洩漏工商秘密、
03 背信等罪及罪刑，另就所涉營業秘密法第13條之2、違反著
04 作權等罪改判不另為無罪諭知；就戎樂天所涉營業秘密法第
05 13條之2、第13條之1之科刑判決，改判無罪及公訴不受理；
06 檢察官不服判決，向最高法院提起上訴。

07 (二)最高法院經審理後，認本院前審判決關於何建廷、王永銘、
08 戎樂天涉犯營業秘密法等部分具有撤銷發回更審之原因；至
09 於王永銘被訴違反著作權法部分，業經前審即本院 109年度
10 刑智上重訴字第 4號刑事判決不另為無罪之諭知，未經檢察
11 官上訴而告確定，是以上開部分已非本案審理範圍。

12 (三)從而，本院本次審理範圍僅限於何建廷、戎樂天涉犯違反營
13 業秘密法部分，王永銘僅限於營業秘密法第13條之2、第13
14 條之1第1項之罪、刑法第317條、第318條之1、第318條之2
15 妨害秘密罪、同法第342條第1項背信罪部分，合先敘明。

16 二、本件告訴人臺灣美光公司有告訴權：

17 又按「刑事訴訟法第232 條所謂犯罪之被害人，指因犯罪行
18 為直接受損害之人。就財產犯罪言，所有權人固為被害人，
19 即對於該財產事實上有使用監督之人，因他人之犯罪行為致
20 其使用監督權受侵害者，亦不失為直接被害人」，最高法院
21 90年度台非字第97號判決意旨可資參照。查，被告何建廷、
22 王永銘原為臺灣美光公司員工，利用任職於臺灣美光公司期
23 間，使用臺灣美光公司之電腦系統，自臺灣美光公司及美國
24 美光公司之伺服器中，取得或持有大量美國美光公司所有而
25 授權臺灣美光公司使用之營業秘密。臺灣美光公司為美國美
26 光公司授權使用營業秘密之合法被授權人（詳後述），就持
27 有之營業秘密享有使用監督之權利，因被告何建廷、王永銘
28 之不法行為致臺灣美光公司使用監督權遭侵害，臺灣美光公
29 司為受害人，依前開說明，自得對侵害營業秘密之犯罪行為
30 人提起告訴。

31 三、證據能力部分：

01 (一)被告以外之人於審判外之言詞或書面陳述，除法律有規定者
02 外，不得作為證據。又被告以外之人於審判外之陳述，雖不
03 符合刑事訴訟法第159條之1至第159條之4之規定，但經當事
04 人於審判程序同意作為證據，法院審酌該言詞陳述或書面陳
05 述作成時之情況，認為適當者，亦得為證據；當事人、代理
06 人或辯護人於法院調查證據時，知有同法第159條第1項不得
07 為證據之情形，而未於言詞辯論終結前聲明異議者，視為有
08 前項之同意。刑事訴訟法第159條第1項及第159條之5分別定
09 有明文。查檢察官、被告何建廷、王永銘及其等辯護人就本
10 判決所引用之被告以外之人於審判外之陳述，於本院準備程
11 序及審理時並未爭執證據能力（參見本院111年度刑智上重
12 更一字第1號卷四第372至443頁、卷十第60頁），且迄言詞
13 辯論終結前亦均未聲明異議，經本院審酌該等證據之作成情
14 況，核無違法取證或其他瑕疵，認均適為本案認定事實之依
15 據，依刑事訴訟法第159條之5規定，均有證據能力。

16 (二)又本件認定事實引用之卷內非供述證據（詳後述），並無證
17 據證明係公務員違背法定程序取得，且與本案待證事實具有
18 自然之關聯性，均有證據能力。

19 貳、實體部分

20 一、認定犯罪所憑之證據及理由：

21 (一)被告何建廷部分：

22 上揭犯罪事實，業據被告何建廷於本院準備程序及審理時均
23 坦承不諱（參見本院111年度刑智上重更一字第1號卷四第15
24 8、364頁、卷十第236頁），並有證人即臺灣美光公司製造工
25 程處處長陳侶菱於調詢、偵訊及原審審理時（參見105年度他
26 字第6099號卷二第118至124頁、第182至187頁、第383至387
27 頁、106年度智訴字第11號卷十三第279至362頁）、證人即臺
28 美光公司資訊部門處長程偉於原審審理時（參見106年度智訴
29 字第11號卷十四第97至98頁、第103至106頁、第129至135頁
30 ）、證人即臺灣美光公司法務經理陳希賢於調詢及原審審理
31 時（參見105年度他字第6099號卷一第132至147頁、106年度

01 智訴字第11號卷十一第71至88頁)、證人即臺灣美光公司整
02 合部經理洪伯昌於原審審理時(參見106年度智訴字第11號卷
03 十三第201至211頁、第233至234頁)、證人即聯電公司資深
04 副總經理陳正坤於調詢及偵訊中(參見105年度他字第6099號
05 卷一第387至393頁、第396至401頁)之證述在卷,復有被告
06 何建廷之人事資料卡影本(參見105年度他字第6099號卷二第
07 203頁)、瑞晶公司與被告何建廷簽署之聘僱合約書影本、
08 臺灣美光公司103年2月24日與被告何建廷簽署之「聘僱合約
09 及保密及智慧財產合約」影本(參見105年度他字第6099號卷
10 二第193至200頁)、無權存取公用資料夾之警語(告證36,參
11 見106年度智訴字第11號卷二十三第171頁)、無權存取資
12 料夾頁面之警語(告證37,參見原審卷二十三第173頁)、臺
13 灣美光公司105年4月19日(105)美光字第0040號函(參見105
14 年度他字第6099號卷二第191至192頁)、臺灣美光公司104
15 年2月26日電子郵件及104年4月28日電子郵件(參見106年度
16 智訴字第11號卷六第435至436頁、卷二十三第177頁)、連
17 接外部雲端網站時顯示之警語(告證41,參見106年度智訴字
18 第11號卷二十三第181頁)、美國美光公司與臺灣美光公司
19 於103年2月28日簽訂之MIT/MMT Design Engineering Servi
20 ces Agreement(參見105年度他字第6099號卷一第206至216
21 頁)、截圖照片(參見106年度智訴字第11號限制閱覽卷一第
22 53至55頁)、附表三編號38所示硬碟內之檔案擷取照片(參
23 見106年度智訴字第11號限制閱覽卷一第207頁、卷二第75
24 頁)、法務部調查局106030案件鑑定報告(參見新北市調查處
25 卷(下稱調查卷)二第570至574頁)、A電磁紀錄暨 B紙本資
26 料所示之檔案資料及扣案之附表三編號25、34、35、36、3
27 7、38所示之物等在卷可稽,俱徵被告何建廷上開自白確與
28 事實相符,堪以採信,從而,本件事證明確,被告何建廷犯
29 行洵堪認定。

30 (二)被告王永銘部分:

上揭犯罪事實，業據被告王永銘於本院準備程序及審理時均坦承不諱（參見本院111年度刑智上重更一字第1號卷四第159、364頁、卷十第236頁），並有證人陳侶菱於調詢、偵訊及原審審理時（參見105年度他字第6099號卷二第118至124頁、第182至187頁、第383至387頁、106年度智訴字第11號卷十三第279頁至361頁）、證人程偉於原審審理時（參見106年度智訴字第11號卷十四第97至123頁）、證人陳希賢於調詢中（參見105年度他字第6099號卷一第132至147頁）、證人即美國美光公司資訊科技安全部門員工J.R. Tiet sort於調詢中（參見105年度他字第6099號卷一第155至163頁）、證人洪伯昌於原審審理時（參見106年度智訴字第11號十三第208頁至234頁）、證人陳正坤於調詢及偵訊（參見105年度他字第6099號卷一第387至393頁、第396至401頁）、證人負責電磁紀錄數位鑑識之承辦人員簡稚軒於原審審理時（參見106年度智訴字第11號卷十四第376至391頁）、證人即曾檢視附表三編號1筆記型電腦內之電磁紀錄映象檔之朱成光於原審審理時（參見106年度智訴字第11號卷二十一第326至349頁）之證述在卷，復有被告王永銘之離職申請單與人資晤談紀錄（參見105年度他字第6099號卷一第73至74頁）、被告王永銘於103年2月26日簽署之「聘僱合約及保密及智慧財產合約」影本（參見105年度他字第6099號卷一第104至121頁）、被告王永銘於105年4月26日簽署之「辭職聲明」（參見105年度他字第6099號卷一第127至131頁）、無權存取公用資料夾之警語（告證36，參見106年度智訴字第11號卷二十三第171頁）、無權存取資料夾頁面之警語（告證37，參見106年度智訴字第11號卷二十三第173頁）、被告王永銘下載美光公司機密檔案紀錄（告證16，參見105年度他字第6099號卷一第83至97頁）、被告王永銘105年3月20日至同年4月26日出勤及門禁刷卡紀錄（參見105年度他字第6099號卷一第78至81頁）、臺灣美光公司104年2月26日電子郵件及104年4月28日電子郵件（參見106年度智訴字第11號卷六第435至436頁、卷

二十三第177頁)、連接外部雲端網站時顯示之警語(告證41, 參見106年度智訴字第11號卷二十三第181頁)、美國美光公司與臺灣美光公司於103年2月28日簽訂之MIT/MMT Design Engineering Services Agreement(參見105年度他字第6099號卷一第206至216頁)、法務部調查局105年10月5日調資伍字第10514003 270號函檢送案件編號105178鑑定報告(參見調查卷二第543至544頁)、法務部調查局新北市調查處106年2月23日調資伍字第00000000000號函檢送案件編號106030鑑識報告(參見調查卷二第570至574頁)、檔案清單(參見調查卷二第575頁)、被告王永銘所用雲端硬碟之檔案清單(參見調查卷二第576至678頁)、C電磁紀錄暨D紙本資料所示之檔案資料及扣案附表三編號1、2、3、6、9、16、19、20、22、24、38所示之物等在卷可稽, 俱徵被告王永銘上開自白確與事實相符, 堪以採信, 從而, 本件事證明確, 被告王永銘犯行洵堪認定。

二、論罪：

(一)被告王永銘行為前, 刑法第359條雖於108年12月25日經修正公布, 同年12月27日施行, 惟查修正前刑法第359條係依刑法施行法第1條之1第2項但書規定將罰金數額提高為3倍, 其修正之結果僅是將修正前之罰金數額調整換算後予以明定, 不生有利或不利於行為人之情形, 自非法律變更, 當亦不生新舊法比較之問題, 而應依一般法律適用原則, 逕行適用裁判時法, 合先敘明。

(二)核被告何建廷所為, 係犯營業秘密法第13條之1第1項第3款之經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀營業秘密, 仍不為刪除、銷毀營業秘密罪及同項第2款之持有營業秘密, 逾越授權範圍而使用該營業秘密罪。被告何建廷所為重製營業秘密之低度行為, 為使用營業秘密之高度行為吸收, 不另論罪。被告何建廷於離職後前往聯電公司期間, 擅自使用該等營業秘密之犯行, 係基同一目的之單一犯意, 在密接時地, 侵害

01 同一法益，各該行為之外在獨立性甚低，可認其主觀上對於
02 前後所實行各該舉動不過為其侵害營業秘密犯行之一部分
03 ，而依一般社會通念，在刑法評價上，以視為數個舉動之接
04 續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，應論以接
05 續犯之一罪。被告何建廷接續為前揭行為而涉犯前開數罪名
06 ，乃屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法第55條前
07 段，從一重之營業秘密法第13條之1第 1項第2款知悉及持有
08 營業秘密逾越授權範圍而使用該營業秘密罪處斷。檢察官起
09 訴書B紙本資料雖未論及附件一(二)編號10至12所示資料，
10 然此部分與附件一(二)編號1至9所示資料有實質上一罪關係
11 ，為起訴效力所及，自應併予審理。檢察官起訴書記載被告
12 何建廷使用附表三編號37所示筆記型電腦讀取使用 A電磁紀
13 錄，然未論及以附表三編號37所示電腦重製如附件一(一)編
14 號1916所示A電磁紀錄，此部分與上開使用A電磁紀錄有實質
15 上一罪關係，為起訴效力所及，自應併予審理。

16 (三)核被告王永銘所為，係犯營業秘密法第13條之1第1項第1款
17 之擅自重製營業秘密後進而使用罪、刑法第359條之無故取
18 得他人電磁紀錄罪。被告王永銘所為重製營業秘密之低度行
19 為，為使用營業秘密之高度行為吸收，不另論罪。被告王永
20 銘於離職前，接續擅自重製而取得告訴人公司之營業秘密及
21 電磁紀錄，又於離職後前往聯電公司期間，擅自重製、使用
22 該等營業秘密之犯行，係基同一目的之單一犯意，在密接時
23 間內，侵害同一法益，各該行為之外在獨立性甚低，可認其
24 主觀上對於前後所實行各該舉動不過為其侵害營業秘密犯行
25 之一部分，而依一般社會通念，在刑法評價上，以視為數個
26 舉動之接續施行，合為包括之一行為予以評價，較為合理，
27 應論以接續犯之一罪。被告王永銘接續為前揭行為而涉犯前
28 開數罪名，乃屬一行為觸犯數罪名之想像競合犯，應依刑法
29 第55條前段，從一重之營業秘密法第13條之1第1項第 1款擅
30 自重製營業秘密後進而使用罪處斷。檢察官起訴書 C電磁紀
31 錄檔案數量為931個，雖未論及其餘150個檔案之部分，然此

01 部分與上開檔案有實質上一罪關係，為起訴效力所及，自應
02 併予審理。檢察官起訴書 D紙本資料雖未論及附件二(二)編
03 號 1所示資料，然此部分與附件二(二)編號 2至15所示資料
04 有實質上一罪關係，為起訴效力所及，自應併予審理。檢察
05 官起訴書記載被告王永銘使用附表三編號 1、2、6所示之物
06 下載重製C電磁紀錄，然未論及以附表三編號5、16、19、20
07 所示之物下載重製如附表二編號4至7所示C電磁紀錄，然此
08 部分與上開附表三編號 1、2、6所示之物下載重製C電磁紀
09 錄有實質上一罪關係，為起訴效力所及，自應併予審理。

10 (四)刑之減輕：

11 1.按證人保護法第14條第1項規定：「第2條所列刑事案件之被
12 告或犯罪嫌疑人，於偵查中供述與該案案情有重要關係之待
13 證事項或其他正犯或共犯之犯罪事證，因而使檢察官得以追
14 訴該案之其他正犯或共犯者，以經檢察官事先同意者為限，
15 就其因供述所涉之犯罪，減輕或免除其刑」。揆其立法目的
16 ，係藉刑罰減免之誘因，以鼓勵刑事案件之被告或犯罪嫌疑
17 人，使其勇於供出與案情有重要關係之待證事項或其他正犯
18 或共犯犯罪之事證，以協助檢察官有效追訴其他正犯或共犯
19 。既稱因而使檢察官「得以追訴」該案之其他正犯或共犯者
20 ，而非繫於必須將其他正犯或共犯予以判決定罪，只要被告
21 或犯罪嫌疑人所供情節並非明顯不合情理，亦非為圖減輕或
22 免除刑責，故意對與案情有重要關係之待證事項為不實之供
23 述，或虛構其他正犯或共犯犯罪之事證，因而使檢察官得以
24 有效偵查起訴該正犯或共犯，即有上開法條規定減輕或免除
25 其刑適用之餘地（最高法院[100年度台上字第 5757](#)號判決意
26 旨參照）。查被告王永銘於偵查中證述關於其他正犯或共犯
27 之犯罪事證，因而使檢察官得以追訴被告戎樂天，復經檢察
28 官事先同意適用證人保護法第14條第1項之規定並載明於偵
29 訊筆錄（參見106年度偵字第4520號卷第106頁），自應就被
30 告王永銘因供述所涉之擅自重製營業秘密後進而使用罪，依
31 證人保護法第14條第1項規定，減輕其刑。

01 2.刑事妥速審判法第 7 條規定：「自第一審繫屬日起已逾八年
02 未能判決確定之案件，除依法應諭知無罪判決者外，法院依
03 職權或被告之聲請，審酌下列事項，認侵害被告受迅速審判
04 之權利，且情節重大，有予適當救濟之必要者，應減輕其刑
05 ：一、訴訟程序之延滯，是否係因被告之事由。二、案件在
06 法律及事實上之複雜程度與訴訟程序延滯之衡平關係。三、
07 其他與迅速審判有關之事項」。查本案於106年9月 8日繫屬
08 原審法院，有原審法院收狀戳章在卷可憑（參見106年度智
09 訴字第11號卷一第1頁），本案歷經原審、本院調查審理，
10 迄至本院宣判時（115年2月13日）為止，案件繫屬已逾 8年
11 未能判決確定。本院審酌本案訴訟程序之延滯，主要因本案
12 證人人數眾多，事實及法律關係繁雜，所需調查之人證、事
13 證甚多，且被告何建廷、王永銘迭經原審及本院審理迄今，
14 均顯無不到庭接受審理而故意延滯之情形，尚無可歸責於被
15 告何建廷、王永銘之事由，經本院審酌刑事妥速審判法上開
16 規定，就彼等之速審權及公共利益之均衡維護，依比例原則
17 及法益權衡原則為客觀判斷，認速審權確已受侵害，且情節
18 重大，有予以適當救濟之必要，爰依刑事妥速審判法第 7 條
19 規定，對被告何建廷、王永銘分別減輕或遞減輕其刑。

20 三、撤銷改判之理由及科刑審酌事由：

21 （一）原審以被告何建廷犯意圖在大陸地區使用、逾越授權範圍而
22 使用營業秘密罪，被告王永銘犯意圖在大陸地區使用而洩漏
23 營業秘密罪、背信罪、無故取得電磁紀錄、洩漏工商秘密等
24 罪，被告戎樂天犯意圖在大陸地區使用而使用他人擅自重製
25 取得之營業秘密罪，事證明確，予以論罪科刑，固屬卓見。
26 然查：

27 1.刑事審判旨在實現刑罰權之分配正義，故法院對於有罪被告
28 之科刑，應符合刑罰相當之原則，使輕重得宜，罰當其罪。
29 本件被告何建廷、王永銘終於本院坦認犯行，此為原審判決
30 所未及審酌，原審對被告何建廷、王永銘所為量刑稍有未
31 洽。

01 2.原判決認被告何建廷、王永銘除分別犯持有營業秘密逾越授
02 權範圍而使用該營業秘密罪、擅自重製營業秘密後進而使用
03 罪外，被告何建廷想像競合犯營業秘密法第13條之 2之意圖
04 在大陸地區使用而使用營業秘密罪，從一重論以意圖在大陸
05 地區使用，逾越授權範圍而使用營業秘密罪。被告王永銘想
06 像競合犯營業秘密法第13條之 2之意圖在大陸地區使用而洩
07 漏營業秘密罪、刑法第317條、第318條之2之利用電腦或其
08 他設備洩漏工商秘密罪、同法第318條之1之無故洩漏因利用
09 電腦或其他相關設備知悉或持有他人之秘密罪、同法第342
10 條第1項之背信罪，從一重論以意圖在大陸地區使用，洩漏
11 營業秘密罪，尚有未洽（詳如後述不另為無罪諭知部分）。

12 3.被告戎樂天並未涉犯違反營業秘密法第13條之2、第13條之1
13 第1項第4款之罪（詳如後述無罪部分），原審未察逕為有罪之
14 諭知，尚有違誤。

15 4.本案自第一審繫屬日起已逾 8年未能判決確定，應依刑事妥
16 速審理法第 7條規定對被告何建廷、王永銘分別（遞）減輕
17 其刑。原審未及審酌，自有未洽。檢察官上訴指摘原審量刑
18 過輕為無理由，被告何建廷、王永銘上訴執此指摘原審量刑
19 過重為有理由，被告戎樂天上訴否認犯行則非無理由，且原
20 判決既有上開可議之處，自應由本院將原判決予以撤銷改判
21 。

22 （二）爰以行為人之責任為基礎，審酌被告何建廷前任職告訴人臺
23 灣美光公司擔任量產整合部課長職務，被告王永銘則擔任告
24 訴人臺灣美光公司擔任製程整合部副理，均明知其等所知悉
25 或持有之上開營業秘密對告訴人具有高度經濟價值，足以影
26 響告訴人於高科技領域之競爭力，被告何建廷竟利用職務上
27 機會，持有附件一所示營業秘密經告知應刪除、銷毀仍未為
28 刪除、銷毀，進而逾越授權範圍而使用該營業秘密，被告王
29 永銘則非法擅自重製取得附件二所示營業秘密之電磁紀錄、
30 紙本資料，進而使用上開營業秘密，致告訴人受有損害，所
31 為實不足取，惟念其等犯後均坦承犯行，且由聯電公司與告

01 訴人達成和解，賠償損害，獲告訴人諒解，此有告訴人刑事
02 陳報狀暨附件資料、刑事撤回告訴狀(參見本院109年度刑智
03 上重訴字第4號卷三十二第475至476頁、第481至483頁、卷
04 三十四第119至121頁)在卷可參，兼衡被告何建廷、王永銘
05 之素行，其等犯罪之動機、目的、手段，及於本院審理時自
06 承之智識程度、工作所得、家庭生活狀況(參見本院111年度
07 刑智上重更一字第1號卷十第241至242頁)等一切情狀，分別
08 量處如主文第二項、第三項所示之刑，並就被告王永銘部分
09 諭知易科罰金之折算標準，資為懲儆。

10 四、附條件緩刑宣告：

11 (一)行為經法院評價為不法之犯罪行為，且為刑罰科處之宣告後
12 究應否加以執行，乃刑罰如何實現之問題。依現代刑法之
13 觀念，在刑罰制裁之實現上，宜採取多元而有彈性之因應方
14 式，除經斟酌再三，認確無教化之可能，應予隔離之外，對
15 於有教化、改善可能者，其刑罰執行與否，則應視刑罰對於
16 行為人之作用而定。倘認有以監禁或治療謀求改善之必要，
17 固須依其應受威嚇與矯治之程度，而分別施以不同之改善措
18 施（入監服刑或在矯治機關接受治療）；反之，如認行為人
19 對於社會規範之認知並無重大偏離，行為控制能力亦無異常
20 僅因偶發、初犯或過失犯罪，刑罰對其效用不大，祇須為
21 刑罰宣示之警示作用，即為已足，此時即非不得緩其刑之執
22 行，並藉違反緩刑規定將入監執行之心理強制作用，謀求行
23 為人自發性之改善更新。而行為人是否有改善之可能性或執
24 行之必要性，固係由法院為綜合之審酌考量，並就審酌考量
25 所得而為預測性之判斷，但當有客觀情狀顯示預測有誤時，
26 亦非全無補救之道，法院仍得在一定之條件下，撤銷緩刑（
27 參刑法第75條、第75條之1），使行為人執行其應執行之刑
28 以符正義。由是觀之，法院是否宣告緩刑，有其自由裁量
29 之職權，祇須行為人符合刑法第74條第1項所定之條件，法
30 院即得宣告緩刑，與行為人犯罪情節是否重大，是否坦認犯
31 行並賠償損失，並無絕對必然之關聯性（最高法院[102年度](#)

01 [台上字第4161](#)號判決意旨參照)。

02 (二)經查，被告何建廷、王永銘前均未曾因故意犯罪受有期徒刑
03 以上刑之宣告，有法院前案紀錄表在卷足稽(參見本院111年
04 度刑智上重更一字第1號卷十第3至13頁、第25至29頁)，因
05 一時失慮，偶罹刑典，且被告何建廷、王永銘於本院審理時
06 坦承錯誤，應已反躬自省，且由聯電公司與告訴人臺灣美光
07 公司成立和解，積極填補損害，獲告訴人諒解，已如前述，
08 被告二人經此偵審教訓，應知所警惕，信無再犯之虞，以刑
09 事法律制裁本即屬最後手段性，刑罰對於被告之效用有限，
10 作為宣示之警示作用即為已足，藉由較諸刑期更為長期之緩
11 刑期間形成心理強制作用，更可達使被告自發性改善更新、
12 戒慎自律之刑罰效果，因認上開刑之宣告以暫不執行為適當
13 ，爰依刑法第74條第 1項第1款規定，均併予宣告緩刑2年，
14 以啟自新。

15 (三)復衡被告何建廷、王永銘犯罪態樣、情節及所生危害，認有
16 課以一定條件之緩刑負擔，促使被告二人更加重視法規範秩
17 序，令被告二人從中記取教訓，隨時警惕，建立正確法律觀
18 念之必要，爰依刑法第74條第2項第5款規定，命被告二人應
19 於緩刑期間內向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社
20 區或其他符合公益目的之機構或團體，各提供100小時、80
21 小時之義務勞務，並依刑法第93條第1項第2款規定，均諭知
22 於緩刑期間付保護管束，以維法秩序之平衡，督促被告二人
23 確實改過遷善，以觀後效。倘被告違反上開負擔情節重大，
24 足認原宣告緩刑難收預期效果，而有執行刑罰之必要者，依
25 刑法第75條之1第 1項第4款規定，其緩刑之宣告得由檢察官
26 向法院聲請撤銷，併此說明。

27 五、沒收：

28 (一)扣案如附表三編號34、36所示之物，為被告何建廷犯罪所得
29 之物，業據被告何建廷於本院準備程序時供述在卷(參見本
30 院111年度刑智上重訴一字第1號卷九第403頁)，應依刑法第
31 38條之1第1項規定宣告沒收。

01 (二)又扣案如附表三編號 9、22、24、38所示之物，為犯罪所生
02 之物，業據被告王永銘於本院準備程序時供述在卷（參見本
03 院111年度刑智上重訴一字第1號卷九第404頁），並有案件鑑
04 識報告(參見調查卷二第570至574頁)在卷可佐，爰依刑法第
05 38條第 2項規定，分別於被告何建廷、王永銘所犯罪刑之主
06 文項下宣告沒收。

07 (三)扣案如附表三編號25、35所示之物，為被告何建廷所有供本
08 案犯行所用，業據被告何建廷於本院準備時供述無訛（參見
09 本院111年度刑智上重訴一字第1號卷九第403頁）；又扣案如
10 附表三編號2、3、5、6、16、20所示之物，為被告王永銘所
11 有供本案犯行所用，業據被告王永銘於本院準備程序時無訛
12 （參見本院111年度刑智上重訴一字第1號卷九第403頁），皆
13 應依刑法第38條第2項規定宣告沒收。

14 (四)至扣案如附表三編號1、19、37所示之物，則非被告何建廷
15 、王永銘二人所有；又附表三編號4、7、8、10、11至15、1
16 7至18、21、23、26至33所示之物，卷內並無證據證明與本
17 案有關，爰均不予宣告沒收。

18 (五)又「犯罪所得」，係指不法行為所得，乃與犯罪有直接關連
19 性之所得、所生之財物及利益（即直接所得），不問物質抑
20 或非物質、動產抑或不動產、有形抑或無形均屬之。具體以
21 言，包括：(1)因為犯罪所獲取之報酬或對價，例如殺人或詐
22 騙集團車手之報酬，專門非法吸金公司員工之薪資（含佣金
23 、業績獎金），販賣毒品、槍枝、偽禁藥或出售攙偽假冒食
24 品之價金，非法匯兌所得之報酬或手續費，皆屬之；(2)產自
25 犯罪之所得，亦即犯罪行為人因實行犯罪過程中所獲取之財
26 物，或財產利益之積極增加或消極不減損，例如竊盜、搶奪
27 、強盜、詐欺、侵占、恐嚇取財或擄人勒贖取得之贓物或贓
28 款，圖利犯罪所圖得之利益、占用他人房屋之使用利益、接
29 受性招待或餐飲之利益、違反銀行法吸收之資金、內線交易
30 之股票增值、逃漏稅捐之稅額、環境犯罪節省之處理費用、
31 法定應建置設備而未建置所減省之費用。查被告何建廷自10

01 4年11月5日起任職聯電公司至106年2月14日為調查官搜索
02 止，自聯電公司所受領之薪資共190萬元及2次自晉華公司領
03 取50萬人民幣；被告王永銘自105年4月28日起任職聯電公司
04 至106年 2月7日起為調查官搜索止，自聯電公司所受領之薪
05 資共195萬元，均為其等以勞力、工作或能力換取之報酬，
06 復依卷內現存證據資料 尚無證據證明被告二人因本案而獲
07 有任何報酬

08 ，爰不宣告沒收、追徵犯罪所得，附此敘明。

09 乙、無罪及不另為無罪部分：

10 一、公訴意旨略以：聯電公司為臺灣首家提供積體電路（Integr
11 ated Circuit, IC）晶圓專業代工服務之公司，早期曾從事
12 DRAM之開發及製造，嗣後結束DRAM之製造業務，將相關技術
13 人員移撥至聯電公司其他部門。直至105年1月間，聯電公司
14 派員與大陸地區福建省晉華集成電路有限公司（下稱晉華公
15 司）洽談，雙方協議進行32奈米DRAM及 32s奈米DRAM相關製
16 程技術開發，由晉華公司提供3億美元資金採購研發設備
17 ，並依開發進度陸續支付聯電公司 4億美元，開發成果由雙
18 方共同擁有，整體技術完成後將轉移至晉華公司進行32奈米
19 DRAM及32s奈米 DRAM之量產。聯電公司為執行前述技術合作
20 案，於105年1月間，在○○市○○○區000000第二廠區成立
21 新事業發展中心(下稱 NBD)，由陳正坤（原臺灣美光公司董
22 事長，於104年7月31日離職，並於104年9月間任職聯電公司
23 資深副總經理，英文姓名Stephen)負責主導，並於 NBD下成
24 立專案技術一處（下稱PM1）、專案技術二處（下稱PM2）及
25 專案技術三處（下稱PM3）等部門，陸續招募原在臺灣美光
26 公司任職之被告何建廷、王永銘等人，且由被告戎樂天擔任
27 PM2部門之協理。PM2下設製程整合一部（下稱PI1）、製程
28 整合二部（下稱PI2）、缺陷分析管理部（下稱DM）及元件
29 部（下稱Device）。聯電公司於105年 3月11日向經濟部投資
30 審議委員會申請核可前述技術合作案，經該會於105年4月12
31 日以經審二字第 10500055030號函准許。聯電公司、晉華公

公司及00000000000000000000(下稱○○○○○)等三方，復於105年11月8日簽訂「00000000000000000000（00000000000000000000000000000000）」，約定將聯電公司所制定之DRAM設計規則轉換為程式碼後，送交○○○○○○進行設計圖修改、反饋、執行程式及晶片設計製作，總額000萬0000美元之設計服務費用均由晉華公司分3期支付予○○○○○○，○○○○○○測試完成並交付GDS檔案及TV1芯片DDR4後，再把整體32/32s奈米DRAM開發技術交晉華公司進行DRAM成品量產。惟被告何建廷、被告王永銘、被告戎樂天為執行聯電公司業務，竟為後述行為：

(一)被告何建廷於105年1月間，已知悉聯電公司開始推動前開技術合作案，成為美國美光公司之競爭對手，而自己所持有之A電磁紀錄及B紙本資料，有助於聯電公司及晉華公司在大陸地區量產DRAM晶圓，竟意圖在大陸地區使用上開營業秘密之犯意，於上開時、地，不為刪除或銷毀A電磁紀錄及B紙本資料，進而逾越臺灣美光公司原授權被告何建廷使用該等資訊之範圍，而以扣案之電腦讀取A電磁紀錄，且將B紙本資料攜帶至PI1辦公室而使用，亦涉犯違反營業秘密法第13條之2第1項之意圖在大陸地區使用而犯同法第13條之1第1項第2款、第3款之罪嫌。

(二)王永銘於105年1、2月間，經由 LINE通訊軟體，與已在聯電公司「新事業發展中心」任職之被告何建廷聯繫，得知聯電公司因與晉華公司合作研發DRAM計畫，需要懂得元件（Device）之人才，雙方進一步接觸後，被告王永銘決定轉職至聯電公司，並透過被告何建廷交付履歷表予聯電公司。被告王永銘因此於105年2月底前往聯電公司，由聯電公司接受該公司人資部門主管被告戎樂天面試。嗣被告王永銘於105年3月25日接獲聯電公司寄送之錄取通知書，遂透過LINE通訊軟體告知被告何建廷此事，被告何建廷因此將被告王永銘視為聯電公司之團隊成員，開始透過LINE通訊軟體與被告王永銘討論聯電公司研發DRAM所遇到之技術問題。而被告王永銘明知

01 聯電公司就DRAM晶圓研發、製造等業務，與美國美光公司有
02 競爭關係，為使自己日後在聯電公司任職時可解決所遭遇之
03 DRAM技術問題，竟意圖在大陸地區使用營業秘密之犯意，於
04 上開時、地，擅自重製C電磁紀錄及列印D紙本資料後，嗣於
05 105年 7月至8月間某日，被告王永銘參加被告戎樂天所主持
06 之 PM2部門早會，並應被告戎樂天之要求，於早會結束後與
07 PI2經理魏銘德留在會議室內，繼續談論魏銘德所提報之F32
08 DRAM「設計規則」初稿。因聯電公司過去主要營運項目為邏
09 輯製程晶圓代工，沒有DRAM相關的設計者手冊，故PI2以聯
10 電公司的65奈米邏輯製程設計者手冊為藍本，前述初稿缺乏
11 DRAM設計規則必要之○0000○ ○ ○00000○ ○ ○000000000○
12 三大類別參數，被告王永銘提出關於離子植入參數(用來控
13 制半導體中雜質量的關鍵程序)之意見。被告戎樂天明知被
14 告王永銘已從臺灣美光公司離職近半年，其所持有之臺灣美
15 光公司資料應係以不正方法所取得，竟意圖在大陸地區使用
16 營業秘密之犯意，要求被告王永銘參考美國美光公司之資料
17 (即DR25nmS設計規則)，與聯電公司F32 DRAM「設計規則」
18 交互比對，將不同部分挑出，標上美國美光公司之DRAM設計
19 規則之穩定數值，填寫包含無法以逆向工程回推之離子植入
20 等相關必要參數，協助完成設計規則中○0000○ ○ ○00000
21 ○ ○ ○000000000○等部分，再交給被告戎樂天審閱，以使聯
22 電公司加速完善F32 DRAM設計規則內容。被告王永銘接受被
23 告戎樂天前開指示後之2至3日內，從聯電公司電腦伺服器下
24 載公版邏輯IC設計規則定稿，自行新增○0000○ ○ ○00000
25 ○ ○ ○0000000000 ○欄位，在聯電公司之十餘張設計規則
26 定稿紙本上，參照 DR25nmS設計規則，填上「width」、
27 「space」等參數(113年9月19日檢察官補充理由書所載如附
28 件三所示，詳本院111年度刑智上重更一字第1號限閱卷第3
29 至17頁)，迅速完成數據新增及修改，再將有使用到DR25nmS
30 設計規則部分參數之紙本當面交付予被告戎樂天，被告戎樂
31 天則將該等紙本轉交予魏銘德，囑咐魏銘德與被告王永銘商

01 討，不知情之魏銘德及 PI2工程師吳國豪因此與被告王永銘
02 討論聯電公司F32 DRAM設計規則之參數穩定度及其他參數
03 值，進而完成聯電公司F32 DRAM設計規則。聯電公司原未設
04 置光照下線組及離子植入專業人員，俟被告王永銘提供DR25
05 nmS設計規則製程參數予聯電公司後，PI2開發F32 DRAM設計
06 規則時，即逕行跳過光學近接干擾修正、蝕刻及黃光等過
07 程，僅 2個月時間便將設計規則完成，交由晶片設計廠商進
08 行下一階段製程，降低製作設計規則所需耗費之時間、金
09 錢、設備及人力成本，被告王永銘亦因工作表現得力，於10
10 6年1月間晉升Device經理。因認被告王永銘亦涉違反營業秘
11 密法第13條之2第 1項之意圖在大陸地區使用而犯同法第13
12 條之1第1項第 1款之罪及刑法第317條之洩漏工商秘密罪、
13 刑法第318條之 1之洩漏利用電腦知悉之他人秘密罪、刑法
14 第342條之第 1項之背信罪；被告戎樂天涉犯違反營業秘密
15 法第13條之2第1項之意圖在大陸地區使用，而犯同法第13條
16 之1第1項第4款之罪嫌。

17 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不
18 能證明被告犯罪者應諭知無罪之判決，刑事訴訟法第 154條
19 第2項、第301條第 1項分別定有明文。次按認定犯罪事實所
20 憑之證據，雖不以直接證據為限，間接證據亦包括在內；然
21 無論直接或間接證據，其為訴訟上之證明，須於通常一般之
22 人均不致於有所懷疑，而得確信其為真實之程度者，始得據
23 之為有罪之認定，倘其證明尚未達到此一程度，而有合理性
24 懷疑之存在時，即難遽採為不利被告之認定（最高法院76年
25 度台上字第 4986號判決可供參照）。再按刑事訴訟法第161
26 條第 1項規定：檢察官就被告犯罪事實，應負舉證責任，並
27 指出證明之方法。因此，檢察官對於起訴之犯罪事實，應負
28 提出證據及說服之實質舉證責任。倘其所提出之證據，不足
29 為被告有罪之積極證明，或其指出證明之方法，無從說服法
30 院以形成被告有罪之心證，基於無罪推定之原則，自應為被
31 告無罪判決之諭知（最高法院 92年度台上字第128號判決足

資參照)。按被告或共犯之自白，不得作為有罪判決之唯一證據，仍應調查其他必要之證據，以察其是否與事實相符，刑事訴訟法第156條第2項定有明文。立法意旨是考量共同被告、共犯間不免存有事實或法律上利害關係，因此推諉、卸責於他人而為虛偽自白之危險性不低，故對於其自白之證據價值予以限制。而此所謂必要之證據（即學理上所稱之補強證據），係指除共犯之自白外，其他足以證明其關於犯罪事實供述真實性之別一證據而言。刑事訴訟法關於被告之自白，法院應調查必要證據，以察其是否與事實相符之規定，係指被告雖自白犯罪，仍應就其他必要證據從事調查，以察其自白之虛實者而言，亦即被告之自白不得作為認定犯罪之唯一證據，而須以補強證據證明其確與事實相符。而所謂補強證據，係指除該自白本身外，其他足資證明自白之犯罪事實具有相當程度真實性之證據而言（最高法院18年上字第1087號、29年上字第1648號、73年台上字第5638號判例、100年度台上字第6181號判決參照）。

三、訊據被告何建廷固坦承違反營業秘密法犯行，惟被告何建廷另辯稱：其自臺灣美光公司離職之際，尚不知聯電公司與晉華公司之本件合作開發案，而在聯電公司讀取美國美光公司之資料檔案僅為個人學習、增加知識之用，並未在工作上直接使用美國美光公司之技術等語；被告王永銘固坦承違反營業秘密法等犯行，惟亦辯稱：其自臺灣美光公司離職前，已知聯電公司研發本件F32 DRAM製程結構係採用韓商三星電子股份有限公司（下稱三星公司）結構，且除附件三所示資料外，其所重製取得之資料檔案僅為個人閱覽參考使用等語；被告戎樂天則堅詞否認有何違反營業秘密法犯行，並辯稱：其不知王永銘自臺灣美光公司離職時有取得任何營業秘密資訊，亦未要求王永銘提供美國美光公司之資訊，更遑論有何意圖在大陸使用之意。又聯電公司本件研發F32 DRAM製程結構係採用三星公司結構，與美國美光公司不同，本件聯電公

司F32 DRAM設計規則與美國美光公司之DR25nmS設計規則，兩者之規定及適用範圍亦不同等語。

四、經查：

(一)聯電公司與晉華公司間雙方協議進行 32奈米DRAM及32s奈米DRAM相關製程技術開發，由晉華公司提供0000000資金採購研發設備，並依開發進度陸續支付聯電公司0000000，開發成果由雙方共同擁有，整體技術完成後將轉移至晉華公司進行 32奈米DRAM及32s奈米DRAM之量產，並由經濟部投資審議委員會於105年 4月12日以經審二字第10500055030號函准許在案。聯電公司、晉華公司及○○○○○○等三方，復約定將聯電公司所制定之DRAM設計規則轉換為程式碼後，送交○○○○○○進行設計圖修改、反饋、執行程式及晶片設計製作，總額0000000000000之設計服務費用均由晉華公司分3期支付予○○○○○○○，○○○○○○測試完成並交付GDS檔案及TV1芯片 DDR4後，再把整體32/32s奈米DRAM開發技術交晉華公司進行DRAM成品量產，並於00000000000「0000000000000000000000000000000000(00000000000000000000)」在案，此部分為被告三人所不爭執，復有經濟部投資審議委員會於105年4月12日以經審二字第10500055030號函、「0000000000000000000000000000000000(00000000000000000000)」在卷可稽。又被告何建廷與晉華公司簽署有勞動合同乙紙，合同期限為0000000000000000000000000000，00000000000000，由被告何建廷擔任技術研發主管一職，從事內存製程技術研發工作，該合約第11條並約定有「甲方(即晉華公司)知悉並同意，本合同簽訂時以及合同期限內，乙方(即被告何建廷)可同時在聯華公司任職並領取薪資，…。乙方保證，前述單位已知悉並同意乙方在甲方任職且不會以此為由追究甲方任何責任..」等情，為被告何建廷於偵訊及原審審理時供述在卷（參見105年度偵字第5612號卷第13頁、106年度智訴字第11號卷十六第341至345頁），並有勞動合同(參見106年度偵字第5612號第66至70頁)在卷可佐，此部分之事實，首堪認定。

01 (二)被告何建廷部分(即營業秘密法第13條之2之罪)：

02 1.公訴意旨固舉經濟部投資審議委員會於105年4月12日以經審
03 二字第10500055030號函、「00000000000000000000【000000
04 00000000000000000000000000】」為據，用以佐證被告何建廷
05 有意圖在大陸地區使用營業秘密之狀況。而依經濟部投資審
06 議委員會於105年 4月12日以經審二字第10500055030號函及
07 0000所載，僅能證明聯電公司與晉華公司間協議由晉華公司
08 出資，由聯電公司進行 32奈米DRAM及32s奈米DRAM相關製程
09 技術開發，技術完成後再交晉華公司量產。另聯電公司、晉
10 華公司及○○○○○○等三方復約定將聯電公司所制定之DR
11 AM設計規則轉換為程式碼後，送交○○○○○○○進行設計圖
12 修改等，費用由晉華公司支付，○○○○○○○測試完成並交
13 付GDS 檔案等資料後，再交由晉華公司進行量產等情，尚無
14 從證明被告何建廷有使用本件營業秘密於上開技術開發並意
15 圖在大陸地區使用之意。

16 2.又依被告何建廷與晉華公司簽署之勞動合同，且被告何建廷
17 於偵訊及原審審理時自承有簽訂上開合約，內容係由晉華公
18 司提供一筆專案獎金(參見106年度偵字第5612號卷第13頁、
19 106年度智訴字第11號卷十六第341至345頁)，核與證人○○
20 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
21 ○○○○○○○○○○○等情(參見105年度他字第6099號卷一第
22 頁397至401頁)相符，然上開證據，僅能證明被告何建廷確
23 實有領取晉華公司所提供專案獎金之事實，尚無法逕認被告
24 何建廷有起訴書所指意圖在大陸地區使用而使用他人營業秘
25 密之犯行。

26 3.關於聯電公司研發本件F32 DRAM之製程結構及設計規則之源
27 由：

28 (1)據證人楊名聲於本院審理時證稱：聯電公司研發F32 DRAM之
29 記憶胞(Cell)結構，經研讀相關資料後研判與三星公司較相
30 近，復從卷附相關會議紀錄中所附之○00000000000000000000
31 0000之簡報資料中(參見本院111年度刑智上重更一字第1號

[illegible]

01 電路佈局圖，再搭配聯電公司自己之製程能力可及於14奈米
02 產品，此為上開週邊電路設計規則之由來。本件聯電公司研
03 發記憶胞的結構與三星公司相似，因三星公司與美光公司在
04 那個世代的記憶胞架構係完全不同，三星公司係3乘2，即字
05 元線與位元線所佔寬度係每個單位面積內有3個字元線跟2個
06 位元線，而美國美光公司當時係2個字元線、3個位元線，整
07 個結構不同。而記憶胞結構不同亦會影響週邊電路佈局之週
08 邊電路設計規則等語（參見本院111年度刑智上重更一字第1
09 號卷八第411至418頁）。

10 (4)由以上各情相互勾稽，益證聯電公司就本件與晉華公司合作
11 開發 F32奈米DRAM係採取三星公司DRAM技術軌跡，而與臺灣
12 美光公司之DRAM技術不同。復酌以美國美光公司本件DR25n
13 mS 設計規則關於「ARRAY」的製程限制適用於記憶區含有電
14 容(Capacitor)的記憶陣列(ARRAY)區域，但有部分例外，如
15 列驅動器(Row Drivers)及感測放大器(Sense Amplifier)
16 ；「PERIPHERAL」的製程限制則適用位於記憶列(Array)
17 週邊的未含有電容(Capacitor)的控制電路區域，此有114年
18 10月23日臺灣美光公司刑事陳報狀在卷可稽(參見本院111年
19 度刑智上重更一字第1號卷九第391至396頁)，而聯電公司關
20 於本件F32 DRAM設計規則中之「ARRAY」、「PERIPHERAL」
21 ，僅適用於邏輯電路區即週邊電路區「PERIPHERAL」，不適
22 用於記憶胞區(CELL)，亦有聯電公司114年11月5日(114)聯
23 法務字第0568號函在卷可佐（參見本院 111年度刑智上重更
24 一字第1號卷九第 413至415頁），益證兩者設計規則之適用
25 範圍顯不相同，則本件聯電公司F32 DRAM設計規則及聯電公
26 司與晉華公司合作之32奈米DRAM相關製程技術開發案，是否
27 有參考臺灣美光公司之 DR25nmS設計規則及相關製程技術之
28 必要，已堪值疑。故被告何建廷辯稱其自臺灣美光公司離職
29 之際，尚不知聯電公司與晉華公司之本件合作開發案，而在
30 聯電公司讀取美國美光公司之資料檔案僅為個人學習、增加

01 知識之用，並未直接使用美國美光公司之技術等語，並非無
02 稽。

03 4.又被告何建廷與被告王永銘之LINE對話紀錄內容，雖顯示：

04 (1)105年6月30日上午1時27分10秒至1時31分10秒：

05 王永銘：4G3C，正E300 PFA。

06 JT何建廷：收到。

07 王永銘：好好反省一下。

08 JT何建廷：下次會議，我會請真正的專家發表意見。

09 (2)105年9月13日下午3時11分46秒至3時16分19秒：

10 王永銘：110s BC poly濃度真有減，我猜對了。

11 JT何建廷：好，那就該。

12 王永銘：叫我家小弟模擬一下。

13 JT何建廷：明天記得報一下。

14 (3)105年12月27日下午2時5分39秒至2時9分5秒：

15 王永銘：110s ST1用HARP Oxide，用000 00取代應該有一
16 般的效果，是嗎？

17 JT何建廷：Harp是SACVD、他的應用與我們的000 00並不同
18 。

19 亦有被告何建廷與被告王永銘之對話擷取照片在卷足稽（參
20 見106年度智訴字第11號卷十六第299頁、第301頁、第303
21 頁），且被告何建廷於原審審理時自承4G3C係爾必達第一顆
22 25奈米製程產品，正E300係爾必達逆向工程的切片Data（參
23 見106年度智訴字第11號卷十六第325至326頁），及證人即被
24 告王永銘於原審審理時證稱：正E300係爾必達產品之橫截面
25 圖，復因教育訓練而知110s係用HARP，且F32 DRAM逆向工程
26 後所採為000 00，始詢問何建廷是否一樣效果等語（參見10
27 6年度智訴字第11號卷第十六第223至234頁），然上開證
28 據，僅能證明被告何建廷與王永銘間有討論、比較美國美光
29 公司、臺灣美光公司、聯電公司之產品編號及數值之事實，
30 尚無從證明被告何建廷有意圖在大陸地區使用而使用本件營
31 業秘密之犯行。

01 6.準此，雖被告何建廷於本院審理時就起訴書所載全部犯行均
02 予以坦認，然起訴書所指其涉犯違反營業秘密法第 13條之2
03 之罪，未據檢察官提出任何證據證明被告何建廷有使用本件
04 美國美光公司之技術在本件 F32奈米DRAM開發技術及意圖在
05 大陸地區使用營業秘密等節，且卷內亦無其他跡證可資補
06 強，故實難僅以被告何建廷之單一自白，即遽認被告何建廷
07 有此部分犯行。

08 (三)被告王永銘部分（即意圖在大陸使用營業秘密罪、洩漏工商
09 秘密罪）、被告戎樂天部分（即意圖在大陸地區使用營業秘
10 密罪）：

11 1.如附件三所示美國美光公司之DRAM設計規則所載參數，為美
12 國美光公司之營業秘密及工商秘密：

13 (1)本件如附件三所示DRAM設計規則所載參數為美國美光公司20
14 奈米製程技術之設計規則，其內容涉及DRAM擴散層、SD注
15 入、NWELL、PWEELL等陣列區(ARRAY)及週邊區(PERIPHERY)設
16 計規則參數等資訊，為記憶體生產之方法、技術或設計，且
17 設計規則參數係相互關連，即使個別參數有逆向工程之可能
18 性，若其整體未能證明遭逆向工程所知悉，其整體仍非一般
19 涉及該類資訊之人所能知悉。又DRAM設計規則係因應不同廠
20 商之製程能力或產品特性而有所差異，每個設計規則之參數
21 組合皆係各設計者經由反覆試驗、調整後，始獲得之研發成
22 果，業據證人洪伯昌於原審審理時證述在卷(參見106年度智
23 訴字第11號卷十三第233至234頁)，足認上開DRAM設計規則
24 所載參數，係美國美光公司累積多年DRAM製程專業經驗及反
25 覆試驗、測試所得之參數，並非一般涉及該領域之人所能知
26 悉，具秘密性。被告戎樂天及其辯護人辯稱不具秘密性，洵
27 非可採。

28 (2)又上開DRAM設計規則所載參數實質上為美國美光公司經過時
29 間、勞力、成本之投入所獲得之資訊，並得據以為產品研
30 發、投入市場之參考，若他人擅自取得、使用或洩漏，理當
31 會節省前述時間、成本等之投資，故而可提升與美國美光公

01 司進行產品競爭之競爭力，並造成秘密所有人經濟利益之損
02 失及競爭優勢之削減，該等資訊自具有經濟價值。

03 (3)再美國美光公司、臺灣美光公司復將上開資訊以電磁紀錄方
04 式保存在具有加密及管制存取功能之電腦伺服器，並採取設
05 定授權帳號、密碼等資訊取得權限管理措施，且臺灣美光公
06 司自105年4月20日起，即不得使用連接電腦與外部儲存設備
07 之一種端口(USB PORT)進行存取、配發之電腦有加密保護措
08 施及無權限存取公用資料夾警語、無權限存取SharePoint資
09 料夾警語等管制措施，並與知悉該等資訊之人員間簽署保密
10 條款，明確約定在僱傭期間或之後，不得直接或間接揭露、
11 使用、取得或允許他人取得機密資訊，所謂機密資訊係公眾
12 一般而言不知悉之資訊或標註「機密」(或類似說明)之資訊
13 ，或其具秘密性或機密性，包含與發明、技術、產品、產品
14 規格、流程、程序、效能及數據、成本與財務資訊、行銷與
15 業務計畫、客戶清單、員工、施工計畫與時程、製造、工具
16 組、「晶圓產能」、產品組合、設施規格、使用或生產之材
17 料、以及設計理合相關之資訊，並應於僱傭期間終止時或於
18 臺灣美光公司要求時，將所有本人擁有掌握而含有機密資訊
19 之文件、紀錄、筆記本或其他可存放機密資訊之物品留予臺
20 灣美光公司，並將此等機密資訊返還予臺灣美光公司、銷毀
21 任何本人擁有或掌握之複本等情，業據證人陳希賢、證人程
22 偉、洪伯昌於原審審理時證述（參見106年度智訴字第11號
23 卷十一第41頁、卷十三第210至211頁、卷十四第 96至98
24 頁、第103至135頁）在卷，復有被告何建廷、王永銘簽署之
25 保密及智慧財產合約、臺灣美光工作規則、美光商業行為與
26 道德準則、臺灣美光104年2月26日電子郵件、104年4月28日
27 電子郵件內容、無權限存取公用資料夾警語、無權存取Shar
28 e Point資料夾警語等（參見105年度他字第6099號卷一第18
29 至19頁、第 47頁、第112至121頁、卷二第210至219頁、106
30 年度智訴字第11號卷六第435至436頁、卷二十三第171頁、

第173頁、第177頁)存卷可考，堪認美國美光公司、臺灣美光公司已採取合理之保密措施。

(4)綜上所述，本件如附件三所示設計規則所載參數具有秘密性、且因其秘密性而具有實際之經濟價值，美國美光公司、臺灣美光公司已採取合理之保密措施，應屬美國美光公司之營業秘密及工商秘密。

2.公訴意旨認被告王永銘受被告戎樂天之指示，將其所持有美國美光公司 DR25nmS設計規則之相關參數提供予被告戎樂天云云。然觀諸證人即共同被告王永銘於調詢、偵訊及原審審理中之證述：

(1)關於證人即共同被告王永銘何時以何方式列印本件美國美光公司DR25nmS設計規則：

證人即共同被告王永銘於調詢中雖稱：扣案物編號C-1-2「DR25nmS Design Rule」資料係105年7、8月間，伊在被告戎樂天指示下，自伊之前備份在Google Drive的美國美光公司業務機密資料中下載並列印成紙本等語(參見106年度偵字第4520號卷第 4至27頁)，然其於偵訊時卻改稱：扣案物編號C-1-2「DR25nmS Design Rule」資料係伊於105年4月間將美國美光公司電子檔帶離後，再於聯電公司任職期間伊在自家將電子檔列印成紙本，並非在105年 7、8月間被告戎樂天召集伊及魏銘德方列印出來等語(參見 106年度偵字第11035號卷一第83至93)，先後證述不一。

(2)關於證人即共同被告王永銘以何方式提供美國美光資料予被告戎樂天：

證人即共同被告王永銘於調詢中稱：伊自備份在Google Drive的美國美光公司業務機密資料中下載爾必達公司的 DRAM設計規則並列印成紙本，再部分參考這份資料，在聯電公司的十餘張設計規則紙本上，每一張都填寫伊認可行的幾組width、space 數字，再交予被告戎樂天這十幾張聯電公司設計規則紙本等語(參見106年度偵字第4520號卷第4至27頁)，於偵訊中則稱：伊有依被告戎樂天之指示，將聯電公司F32

01 的DRAM設計規則作審核，依據伊所看到的美國美光公司文
02 件，將聯電公司設計規則上的一些規格不正確部分標示出來
03 等語（參見106年度偵字第4520號卷第92至108頁），前後證
04 述亦不一致。

05 (3)關於被告戎樂天是否知悉被告王永銘持有本件美國美光公司
06 DR25nmS設計規則：

07 證人即共同被告王永銘於調詢中雖稱：105年 7、8月間，被
08 告戎樂天向伊表示，聯電公司正在開發 F32的DRAM，欲制定
09 設計規則，又知悉伊手邊有美國美光公司DRAM設計規則，始
10 要求伊想辦法提供美國美光公司或爾必達公司的DRAM設計規
11 則等語(參見106年度偵字第4520號卷第4至27頁)，然其於偵
12 訊時卻改稱：被告戎樂天請伊以美國美光公司的這部分資
13 料，再參酌自己的想法，填寫相關必要參數，交予被告戎樂
14 天，被告戎樂天始悉伊手頭上有美國美光公司的相關資料；
15 檢調人員至辦公室搜索時，被告戎樂天向伊及何建廷表示，
16 倘若有美國美光公司相關東西即移除，被告戎樂天既然這樣
17 告知，他應該知道伊手邊有美國美光公司的東西等語(參見1
18 06年度偵字第4520號卷第243至253頁)，再於原審審理具結
19 證稱：伊不知道被告戎樂天是否知悉伊有將美國美光公司資
20 料帶至聯電公司，但伊未曾告知被告戎樂天過等語(參見106
21 年度智訴字第11號卷十六第206至209頁)，先後證述歧異。

22 (4)況且，被告王永銘於調詢中雖稱：伊下載列印聯電公司公版
23 的邏輯IC的設計規則定稿(未包含CELL、ARRAY、PERIPHER
24 Y)，自行新增CELL、ARRAY、PERIPHERY欄位，再依據美國美
25 光公司的資料填載數據云云，但其此部分證述難認與事實相
26 符：觀諸卷附聯電公司定稿之F32的DRAM設計規則（參見106
27 年度偵字第4520號卷第49至88頁），其上僅有ARRAY、PERIP
28 HERY欄位及數據，並未包含CELL欄位，又上開設計規則適用
29 範圍為邏輯電路區，並未包含記憶胞區（CELL），亦有聯電
30 公司114年11月5日(114)聯法務字第0568號函在卷可稽(參見
31 本院111年度刑智上重更一字第1號卷九第413至415頁)，且

01 聯電公司之CELL區另有000 0000 000 0000 00000 0000規定
02 (參見本院111年度刑智上重更一字第1號限閱卷第235頁)，
03 是證人王永銘於調詢中稱：有提供美國美光公司之參數並填
04 載在CELL、ARRAY、PERIPHERY欄位云云，可信性堪疑。至檢
05 察官雖主張本件被告王永銘所下載美國美光公司 DR25nmS設
06 計規則紙本資料上有被告王永銘私自註記「55」字樣於本件
07 所參考之參數上，然此僅能證明被告王永銘有私自參考上開
08 設計規則參數，尚無法佐證被告王永銘有提供本件美國美光
09 公司之設計規則參數予被告戎樂天或聯電公司，附此敘明。
10 (5)證人即共同被告王永銘於調詢時亦證稱：魏銘德事後拿到設
11 計規則後(應係被告戎樂天轉交)，有詢問伊其他參數欲如何
12 決定，魏銘德之部屬吳國豪及另名同事嗣後亦有詢問伊參數
13 如何設定云云(參見106年度偵字第4520號卷第4至27頁)，實
14 與證人魏銘德於本院審理時證稱：F32設計規則開發涉及許
15 多部門，每個部門均會根據專業提供適當建議，提供方式一
16 為寄送電子郵件，另一為手寫的，而被告王永銘為元件部門
17 主管，亦會參與設計規則工程層面談論，但伊無印象被告王
18 永銘有提供紙本資料予伊等語(參見本院109年度刑智上重訴
19 字第9號卷二十八第31至74頁)；證人吳國豪於調詢時證稱：
20 被告戎樂天、王永銘或魏銘德未曾提供DRAM Design Rules
21 資料予伊等部門，通常此些資料亦非他們提供，但伊確實會
22 與被告王永銘討論Design Rules，因被告王永銘曾任職DRAM
23 廠而具DRAM設計理念及經驗，伊曾向被告王永銘表示所設計
24 之設計圖，依公司目前製程無法做到，可否修改設計圖，但
25 被告王永銘會提出理論來說服等語(參見本院109年度刑智上
26 重訴字第 9號卷二十五第381至450頁)不同，此外，卷內並
27 無任何有關被告王永銘所述提供美國美光公司DR25nmS設計
28 規則之補強證據，則被告戎樂天有無公訴意旨所指要求被告
29 王永銘提供美國美光公司 DR25nmS設計規則之相關參數之犯
30 行，甚屬有疑。

01 (6)至證人魏銘德雖於調詢、偵訊時證稱：105年9月前後，被告
02 戎樂天有交付伊數張手寫的 DESIGN RULE參數數值紙本，並
03 表示可找被告王永銘討論，上開紙本係手寫手繪等語（參見
04 見105年度他字第6099號卷二第 248至264頁、第314至328
05 頁），然於本院審理時改證稱：伊沒印象戎樂天有交付伊de
06 s ign rule紙本資料等語（參見本院109年度刑智上重訴字
07 第卷二十八第7至74頁），可見證人魏銘德於本院審理已翻異
08 前詞，其於警詢、偵查中證述之可信性，更有疑問。證人魏
09 銘德所述係提供手寫手繪之design rule，亦與被告王永銘
10 於調詢時供稱：伊在聯電公司十餘張設計規則紙本上，填載
11 伊認可行之幾組width、space數字，再交予被告戎樂天等語
12 （參見106年度偵字第4520號卷第4至27頁）不相吻合，尚難
13 以此為不利於被告戎樂天之認定。又證人吳國豪先於調詢證
14 稱：被告戎樂天、王永銘或魏銘德未曾提供DRAM Design Ru
15 les資料予伊等部門，通常此些資料並非他們提供等語（參見
16 本院109年度刑智上重訴字第4號卷二十五第381至450頁），
17 復於偵訊證稱：魏銘德有提供設計規則文件，並表示可與被
18 告王永銘談論設計規則版本差異性等語（參見 105年度他字
19 第6099號卷二第230至241頁、第314至328頁），前後所述已
20 有不一致之情。而證人吳國豪所述曾向被告王永銘表示所設
21 計之設計圖，依公司現行製程無法做到，可否修改設計圖，
22 但被告王永銘會提出理論來說服等情（參見本院109年度刑智
23 上重訴字第4號卷二十五第381至450頁），亦與被告王永銘
24 於調詢時供稱：吳國豪及另名同事曾詢問伊設計規則之參數
25 如何設定等語（參見106年度偵字第4520號卷第4至27頁）迥
26 然有異，則證人吳國豪非但先後所述不一，亦與被告王永銘
27 所述不符，尤難憑其於偵查之證述，遽為不利於被告戎樂天
28 之認定。

29 (7)從而，共同被告王永銘所為不利於被告戎樂天之證述，既有
30 前揭瑕疵，此外，卷內並無被告王永銘所述填載美國美光公
31 司DR25nmS 設計規則參數之聯電公司設計規則定稿資料，亦

01 無任何有關被告王永銘所述提供美國美光公司 DR25nmS設計
02 規則之補強證據，依前開說明，既乏補強證據以擔保共犯即
03 王永銘此部分證詞之真實性，尚難僅憑其單一證述，即遽認
04 被告戎樂天有公訴意旨所指意圖在大陸地區使用而取得、使
05 用該等營業秘密之犯行。

06 3.公訴意旨認比對如附件三所示美國美光公司及聯電公司之設
07 計規則所載參數相同，即遽認定聯電公司之本件設計規則有
08 使用臺灣美光公司設計規則之參數云云。然查：

09 (1)觀諸卷附聯電公司本件F32 DRAM Design Rule版本差異表
10 (參見本院109年度刑智上重訴字第4號限閱卷四第249至279
11 頁)，迄案發遭查獲後，本件F32 DRAM Design Rule總變更
12 次數有 402次，然互核如附件三所示聯電公司之設計規則參
13 數與聯電公司本件DRAM Design Rule版本差異表所載，顯示
14 僅如附件三編號 3至12、16至19所示聯電公司本件設計規則
15 迄查獲時有修改紀錄，其餘聯電公司本件設計規則參數均無
16 修改紀錄，則公訴意旨認聯電公司之本件設計規則有使用美
17 光公司之設計規則參數云云，尚值存疑。

18 (2)又經本院函詢臺灣美光公司關於本件 DR25nmS設計規則中之
19 ○00000○000000000000○區域之定義及其適用範圍，經
20 臺灣美光公司表示○ 00000○0000000000000000000000000000
21 ○00
22 ○0000000000 000000000000000000000000000000 000000000000
23 ○ 00
24 ○000000000000000000000000000000000000等情，此有1
25 14年10月23日臺灣美光公司刑事陳報狀在卷可稽(參見本院1
26 11年度刑智上重更一字第1號卷九第391至396頁)，另參諸美
27 國美光公司本件DR25nmS設計規則第2頁所載00000○00000000
28 000 000000 00000之適用範圍(參見本院111年度刑智上重
29 更一字第1號限閱卷第266頁)，其中1-1 00000000 00 00000
30 000000 00000○000000○0000000000000000000000000000 0
31 000000 0000 00000000000000 0000000000000000000000000000 0000 0000 0

000 000000 000000○00000000000○0000 00000000 00 00
00000000 000000 00000○00000000000○00000000000
00000000○00000000000000000000。再本院亦函詢聯電公
司關於本件F32 DRAM設計規則中之「ARRAY」、「PERIPHERA
L」區域之定義及其適用範圍，經聯電公司函覆表示本件設
計規則僅適用於邏輯電路區即週邊電路區「PERIPHERAL」，
不適用於記憶胞區(CELL)。又在邏輯電路區內，若布局呈現
高度規則性排列，部分會以000○00000○0000標示為陣列區
(ARRAY)。陣列區內包含多種類型的電路模組，其中以00○
0000標示之區域，對應於感測放大器(Sense Amplifier)、
以000○0000 標示之區域，對應於字線驅動電路(Word Lin
e Driver)，此外，字線/位元線解碼器(Word line/Bitlin
e Decoders)亦屬此區等情，此有聯電公司114年11月5日(1
14)聯法務字第 0568號函在卷可佐(參見本院111年度刑智
上重更一字第1號卷九第413至415頁)，益證兩者設計規則之
適用範圍顯不相同，則本件美國美光公司之 DR25nmS設計規
則參數是否有助於聯電公司解決本件研發F32 DRAM設計規則
所遭遇之相關問題，已堪存疑。

(3)復經本院比對如附件三所示美國美光公司及聯電公司之設計
規則(參見本院111年度刑智上重更一字第1號卷限閱卷第43
至48頁)，認定兩者規定之差異如下：

①如附件三編號1所示設計規則，聯電公司之設計規則0000 00
00000000 00000 000000 00000000000000，係定義 000000
00000(○000000)並未界定N+或P+，亦即無論N+或P+均適
用該設計規則，即一般通用規則，其最小寬度為000000；美
國美光公司之設計規則2-3) Active area in array & peri
phery area(擴散層) No.1-1)「N+/ P+ active width for
Well/Sub Contact active area(minimum) Well給電」主要
係適用於Well/SUB CONTACT主動區。聯電公司則未有前述之
限定，故兩者存在差異性。

01 ②如附件三編號2所示設計規則，聯電公司之設計規則0000 00
02 00000000 00000 000000 0000000000000，定義兩主動區間之
03 最小間距或一個主動區之凹口（ notch）寬度二者數值最小
04 距離為000000 000000，並未限定使用區域，即適用於「Arr
05 ay」、「Periphery」區；美國美光公司之設計規則2-3) Ac
06 tive area in array & periphery area(拓散層)(No.3)
07 ，一般規則採140nm，依備註欄所載，「80nm」乃例外規則
08 ，用於感測放大器(SAMP)、子字線驅動器(SWD)區域內始適
09 用。聯電公司之設計規則係用於(ARRAY+Periphery)之周邊
10 區域兩主動區間之最小間距或一個主動區之凹口(notch)寬
11 度二者數值最小距離為000000 000000，而美國美光公司之
12 設計規則則限制於array區中之SAMP, SWD內之兩主動區之最
13 小間距為80nm。聯電公司此規則之適用範圍較美國美光公司
14 廣，兩者適用範圍未盡相同。

15 ③如附件三編號3所示設計規則，聯電公司之設計規則000000
16 000000000000000 00000 000000 00000000000000與美國美光
17 公司之設計規則8-3)SD ion implantation(SD注入)(N0.1)
18 ，二者數值大小均為000000 0000000，聯電公司之設計規
19 則係用以表示0000000000區(依其定義即為00000○)之0○○
20 ○○○0000區之間距最小寬度為000000 0000000。美國美光公
21 司之之ARRAY區N型摻雜區(SD)區(F32-6F) Array亦採相同參
22 數， 兩者採用之參數相同。然聯電公司的○00000000000000
23 0○與美國美光公司的 Array所定義之區域並未完全相同。

24 ④如附件三編號4所示設計規則，聯電公司之設計規則0000000
25 00000000000000 00000 000000 000000000000000與美國美光
26 公司之設計規則8-3)SD ion implantation(SD 注入)(No.1
27)，二者數值大小均為000000000000000，且聯電公司設計規則
28 係定義非000○00000○00000○00000○0○0○○○00○○○
29 ○0000○0○○○○○○○○00000○最小寬度為00000000000000
30 ；依美國美光公司設計規則係為(F32-6F) Periphery採用4
31 20nm，依據聯電公司設計規則就其適用範圍與美國美光公司

規則相同。然聯電公司的○000000 0000000000000000○與美國美光公司的 Per. 兩者定義並非相同，其適用範圍並非相同。

⑤如附件三編號5所示設計規則，聯電公司之設計規則000000 000000000000 00000 000000 00000000000000與美國美光公司之設計規則13-1) Nwell：反轉(No.1)，二者數值大小均為00 00000000，聯電公司之設計規則為○000000 00000 00000000 0000000000000000○表示適用array以外之周邊區之N_WELL寬度。美國美光公司之Periphery區之N_WELL寬度亦採相同參數，兩者採用之參數雖相同。然聯電公司的○000000 0000 000000000000○與美國美光公司的Periphery所定義之區域並非相同，適用範圍不同，故兩者並非完全相同。

⑥如附件三編號6所示設計規則，聯電公司之設計規則0000 00 0 000000000000 00000 000000 0000000000000000與美國美光公司之設計規則13-1) Nwell：反轉(No.1)，二者數值大小均為00000 00000000，聯電公司設計規格為○000000 00000 0000 000000000000○表示適用array區之N_WELL寬度。美國美光公司之 Array區之N_WELL寬度亦採相同參數，兩者採用之參數相同。然聯電公司的○0000000000000000○與美國美光公司的Array區所界定區域並非相同，故兩者並非完全相同。

⑦如附件三編號7所示設計規則，聯電公司之設計規則0000 00 0 000000000000 00000 000000 00000000000000與美國美光公司之設計規則13-1) Nwell：反轉(No.2)，二者數值大小均為0 0000 0000000000，聯電公司設計規格與美國美光公司之N_WELL間距寬度採用相同參數。然美國美光公司係限定於 NWell為固定電位，聯電公司之設計規則則無此限定，故兩者存在差異性。

⑧如附件三編號8所示設計規則，聯電公司之設計規則0000 00 0000000000 00000 000000 00000○00000○與美國美光公司

之設計規則13-2)Pwell:正轉 (NO.1) , 二者數值大小均為0000 00000000, 聯電公司設計規格與美國美光公司之P_WELL間距寬度採相同參數。聯電公司之該設計規則適用於所有區域 (除Cell以外之區域即包含Array及Periphery) , 美國美光公司之設計規則亦適用之Array (含MC區) 及Periphery, 故適用範圍不同。

⑨如附件三編號9所示設計規則, 聯電公司之設計規則0000 0000000000 00000 000000 000000000000與美國美光公司之設計規則13-2) Pwell:正轉 (NO.2) , 二者數值大小均為00000 0000000, 聯電公司設計規格為0000000 00000 0000000000000表示適用array區之P_WELL寬度。美國美光公司之Array區之 P_WELL寬度亦採相同參數, 兩者採用之參數相同, 惟聯電公司之00000000000000000與美國美光公司的 Array兩者定義並非相同, 美國美光公司另規定限定在固定電位, 聯電公司則無該限制。故兩者存在差異性。

⑩如附件三編號10所示設計規則, 聯電公司之設計規則000000 0 0 00000000 00000 000000 000000000000000與美國美光公司之設計規則13-2)Pwell:正轉(NO.2), 二者數值大小均為0000000000000, 聯電公司設計規格為0000000 00000 000000 000 0000000000000表示適用array以外 (包含周邊區) 之P_WELL寬度。美國美光公司之Periphery區之 P_WELL寬度亦採相同參數, 惟聯電公司之0000000 0000000000000000與美國美光公司的 Periphery區兩者定義並非完全相同, 且美國美光公司另有規定限定在固定電位, 聯電公司則無該限制, 故兩者存在差異性。

⑪如附件三編號 11所示設計規則, 聯電公司之設計規則0000 0000000000000000 00000 000000 00000000000000與美國美光公司之設計規則13-4)DNwell: 反轉(No.5), 二者數值大小均為00000 0000000, 聯電公司設計規格與美國美光公司之DN well寬度採相同參數, 且聯電公司設計規則未特定適用範圍, 即一般規則, 即適用於cell區以外之周邊區域(包

含Array+周邊區)；美國美光公司設計規則亦適用於Array(包含MC區)+Periphery區。由於美國美光公司與聯電公司之Array、Periphery定義不同，故兩者設計規則並非相同。

⑫如附件三編號12所示設計規則，聯電公司之設計規則000000 00 0000000000000000 00000 000000 00000○0000000與美國美光公司之設計規則13-4) DNwell：反轉(No. 4)，二者數值大小均為00000 000000000，聯電公司設計規格與美國美光公司之DNwell間距採相同參數。且聯電公司設計規則未特定適用範圍，即一般規則，即適用於 cell區以外之周邊區域（包含Array+周邊區）；美國美光公司設計規則適用於Array（含MC區）+Periphery區，故兩者適用範圍不同。

⑬如附件三編號13所示設計規則，聯電公司之設計規則000000 0 0000000000000000 000000 000000000000與美國美光公司之設計規則2-3)Active area in array & periphery area（擴散層）」(No. 7)，二者數值相同，單位不同，聯電公司設計規則係00000，而美國美光設計規則係000000（um平方）亦表示面積。再聯電公司設計規則係00000，係適用於記憶胞以外之所有主動區域都適用。再者，美國美光公司設計規則之Array（包含MC區）及 Per. 區之主動區面積係採設計規則，雖於備註欄另針對SAP、SAN及YSW（Y方向sub word）區域訂有例外規則，其數值分別為0.107um、0.150um及0.167um，兩者數值相同，惟因兩者定義之 Array及Periphery區不同，故兩者適用範圍存在差異性。

⑭如附件三編號14所示設計規則，聯電公司之設計規則0000 0 00000○00○00000 000000 00000○0000○與美國美光公司之設計規則2-3) Active area in array & Periphery area（擴散層）」(No. 10)，二者數值大小均為「○000」，數值相同。且適用於MC（記憶胞）區以外之Array+Per. 區，兩者適用範圍相同。聯電公司設計規則係用以 150×150um²框框面積，並以每0000為增量單位去做檢查，美國美光公司設計規則係以20×20um²為框框單位，且於X、Y方向上分別以10

隔離(STI)，而由聯電公司設計規則之描述及圖例可知並未限定是否於PN隔離結構，即二者所適用之區域並不相同。

⑰如附件三編號 17所示設計規則，聯電公司之設計規則00000000000000000000 000000 000000000000000000與臺灣美光公司之設計規則13-1) Nwell：反轉(No.5)，二者數值雖均為0000 0000000。聯電公司設計規則定義為○0000000 00○0000000 00 000000000 0000 000000000000000○參考【聯電公司設計規則第15頁圖例】標示0000，美國美光設計規則則定義「overlap margin N well to P+ active area(minimum) (transistor)」表示N型井內與P+主動區間重疊之部分，參酌【美國美光公司設計規則第45頁圖例】該上開定義為圖中之標號(b)係為標號b，兩者定義不相同，故聯電公司及美國美光公司之該條設計規則不同。

⑱如附件三編號18所示設計規則，聯電公司之設計規則000000000000000000000000 000000 000000000000000000與美國美光公司之設計規則13-4) DNwell：反轉(No.3)，二者數值(000 00000000)相同，均在規範N型井至深N型井之間距。至於聯電公司雖然有規定「0000000 00 000000000000 00 000000 00 000000000000000000000000○界定000000000000○0000000兩者為非等電位的條件之間距，美國美光公司並未有該規定，故兩者存在差異性。

⑲如附件三編號19所示設計規則，聯電公司之設計規則000000000000000000000000 000000 000000000000000000與美國美光公司之設計規則8-3)SD ion implantation(SD注入)(No.2)，二者數值均為000000 (0000)，均為0000000000000000○○○○○○○○)中定義陣列區之 N+植入區寬度。聯電公司設計規則中定義○0000 0000000000000000○及適用於 CELL以外的Array區，美國美光公司之設計規定亦適用於MC以外之Array區域，故兩者數值相同，另由聯電公司設計規則NO. NSD. W1.1規定000000 000000000000000000 (○○○○○)數值○0000，與聯電公司設計規則亦相同。惟聯電公司之○0000000000000000

01 值。然聯電公司設計規則關於DNwell之相關規定，並未見有
02 相同的規定。

03 ②如附件三編號24所示設計規則，臺灣美光公司之設計規則13
04 -4) DNwell：反轉「No.9」, item欄記載「Overlap b/w DNw
05 ell and Well Con N+ Active」、「Distance b/w DN well
06 and WellCon N+Active」，並記載「free」，並無任何數
07 值。然聯電公司設計規則關於DNwell之相關規定，並未見有
08 相同的規定。

09 (4)綜上，如附件三所示美國美光公司及聯電公司之設計規則，兩
10 者存有上開差異，兩者設計規則之適用範圍顯不相同，又本案
11 聯電公司之設計規則僅係規範週邊電路區，並非業界爭相競爭
12 之記憶細胞區，且附件三所示之設計規則僅佔本案聯電公司設
13 計規則300餘條規則中之 24條，尚難逕以本案聯電公司之部分
14 設計規則與臺灣美光公司之設計規則參數相同，即遽認聯電公
15 司之設計規則有參考臺灣美光公司之設計規則。故被告戎樂天
16 辯稱兩者設計規則之規定及適用範圍不同，尚非子虛。

17 4.關於聯電公司研發本件F32 DRAM之製程結構及設計規則之源由
18 :

19 (1)證人楊名聲於本院審理時證稱：聯電公司研發F32 DRAM之記憶
20 胞(Cell)結構，經研讀相關資料後研判與三星公司較相近，復
21 從卷附相關會議紀錄中所附之○000000000000000000000000之簡
22 報資料中(參見本院111年度刑智上重更一字第1號卷八第265至
23 282頁)，有提及Air Gap Technology Request，表示欲發展
24 三星公司之Air Gap的技術，簡報中的圖亦係聯電公司逆向工
25 程三星公司20奈米製程產品而來。另在卷附檔名00000000 000
26 00○○○ 000 00000000000000 (參見本院111年度刑智上重更
27 一字第1號限覽卷第237至263頁)，此檔案資料將製造流程的圖
28 逐一列出，上開流程圖亦係逆向工程三星公司產品報告所得，
29 顯見示聯電公司105年討論研發 F32 DRAM製程時，均係參考三
30 星公司半導體製程技術。又伊受託以逆向工程分析聯電公司及
31 美國美光公司各自DRAM結構，分析結果發現兩家公司晶片元件

及製程存有明顯差異，包含主動區域/淺溝槽絕緣、埋入式字元線、位元線接觸、儲存節點墊、儲存節點及金屬接線等層別，微結構不同，製程亦不同，晶片元件不同，亦影響後續相關製程、設備及製程參數，包含元件、電路的設計。聯電公司根據三星公司DRAM結構所推演出的這些製程結構，與美國美光公司不同，顯無法直接使用。再聯電公司F32 DRAM設計規則係自聯電公司 65奈米邏輯0000000000的製程而來，復經比對聯電公司 0000 0000 0000000 000000000000 000000 0000 0○00000 0000 0000第14頁與聯電公司0000 00000 000 0000000000 0000 0000 000000000000 000000 00000000 000000000000 000000 000000 000000000000 000000 0000 00○0○0000000000000000第 21頁所列十項規則中，除第6及第9項之數值不同外，其餘條次之數值均相同，且由圖示顯示結構布局亦同。另根據當時的合作廠商○0000○0，在2016年2月份的月會裡有討論設計規則，設計月報亦提及斯時所謂閘極的最小寬度為00○0，因聯電公司0000 00000 000 00000 0000 000000000 000000000000 00000 0000000 000000000000 00 0000 0000 000 0第33頁中之0000000000000000000000 000000 00 000○000000000○0000，始採為版本。至卷附之附件三編號3至12所示聯電公司設計規則：①如附件三編號3所示○000000○這條參數是0000，這條設計規則在P2版本時係0000，P3版本係0000。從設計規則內所附之圖示來看，00係指有虛線之框，又設計規則有提及00000000和00000000是等值的，00000000，再0000000000的寬度（width），及0000000○0000000000這邊有一個所謂Enclosure的寬度，這兩個寬度加起來，始等於這個數值。另設計規則N+章節所載0000000000 00000○000○為兩部分組成（1）Active width（2）兩倍的0000000000 0000000000 00 0000000 000 0000 000000000 000。而Active的width 是據○0000○00在2016年5月11日會議記錄內，有提供聯電公司GDS file並解析到 Active的最小寬度（width）是0000。復根據2016年7月11日0000跟聯電公司的會議記錄內，有提到00 0000000000 000000，Array的區域是0000，兩邊都是0000，Active的width是000

00，故0000再加上兩倍的0000等於0000，此為Active space之計算方式。②如附件三編號 4所示(00000000)這條設計規則係解析○○000000之GDS file所得之參數為0000。雖據聯電公司0000 00000 000 0000000000 00000000 000000000000 00000 000000 000000000000 000000 0000 000 0第18頁中之0000000000 00 00000 00 000000000000000000之參數為0000，此參考值可顯示聯電公司之現製程能力，而現聯電公司F32 DRAM設計規則訂定0000，即表示聯電公司之製程能力可及此，然因尚未經製程驗證並僅為參考值。③如附件三編號11所示(000000)這條設計規則之參數為000；④如附件三編號12所示(000000)這條設計規則之參數為000。這兩條設計規則係2016年 7月11日在000 0的會議紀錄直接建立width是000和000。雖據聯電公司0000 0 0000 000 0000000000 000000000 000000000000 00000 00000000 000000000000 000000 0000 000 0第19頁中之00000000000 000000 000000000○0○0000000 000 00000 00 000000000000 00 00000 00000000○00000000是000，上開聯電公司F32 DRAM設計規則訂定參數較小，然聯電公司當時製程能力已可及於0及000，但廠商要求000及000，故聯電公司F32 DRAM設計規則即按照廠商要求訂定，然因尚未經製程驗證而僅為參考值及底稿。⑤如附件三編號5所示(00000)這條設計規則係解析000之GDS file所得之參數為 0，故聯電F32 DRAM設計規則亦訂定參數為0。⑥如附件三編號6所示(0000000)這條設計規則參數為000，而此部分聯電公司解析000之GDS file所得之參數為0，不清楚為何聯電F32 DRAM設計規則訂定參數為000，然上開參數係聯電公司之製程能力可及之，且因尚未經製程驗證，僅為參考值，故認聯電公司F32 DRAM設計規則訂定參數為000屬合理範圍內之參考值。⑦如附件三編號 7所示(00000)這條設計規則參數為0 00，而此部分聯電公司解析000之GDS file所得之參數為000 0。⑧如附件三編號8所示(00000)這條設計規則參數為000；⑨如附件三編號9所示 (00000)這條設計規則參數為000；⑩如附件三編號10所示 (0000000)這條設計規則參數為0。所謂CMOS

01 製程，在邏輯區CMOS的製程中 N_WELL佈局圖及P_WELL佈局
02 圖，這兩個圖形是互補，故000000 00000○0 00000 00000
03 ○000000 00000○000000 00000，兩者是互補的。而0000
04 000000000000 00000 000000 0000000000這個規定在聯電公司F
05 32 DRAM設計規則P3版本並未列出，因聯電公司從事邏輯製
06 程，知悉N_WELL跟 P_WELL兩者互補，故聯電公司F32 DRAM設
07 計規則一開始並未將P-WELL部分列入規定，但聯電公司F32 DR
08 AM設計規則係據廠商回饋告知DRAM情況不同始在P3版本出現上
09 開規定。又000000 000000000000○000000 00000 0000000
10 之參數為000，000000 00000 0000000○000000 00000000000
11 0000之參數為000，000000 0000000000000○等於00000000000
12 00000000之參數為0，此為上開三條規定之由來等語（參見本院
13 109年度刑智上重訴字第9號卷三十第119至160頁），且有證人
14 楊名聲提出之聯電公司與美光公司動態隨機存取記憶體晶片元
15 件設計與製程分析報告、○000000000000000000000000、000000
16 0 00000○0000 0000資料、○00000000 0000 0000000 00
17 0000000000 000000 00000○0000000000000、○0000 0000
18 00000 000 000000000 00000000 000000000000 00000 0000000
19 000000000000 000000 0000 000 0（○000000000000）、庭
20 呈之設計規則十條簡報（參見本院109年度刑智上重訴字第4號
21 限閱卷四第227至247頁、第281至291頁、111年度刑智上重更
22 一字第1號限閱卷第237至263頁、第329至605頁）在卷可稽。

23 (2)證人即聯電公司員工劉立偉於本院審理時證稱：聯電公司本件
24 F32 DRAM設計規則係以聯電公司 65奈米邏輯MIXEDMODE之設計
25 規則為基礎出發，並配合客戶○0000000○之需求，即客戶○
26 0000000○有提供之前在其他公司設計使用週邊電路設計圖之G
27 DS予聯電公司，GDS係圖形化之檔案，聯電公司有以電腦軟體
28 分析GDS而得出各式各樣設計圖之圖形，進而知悉客戶之需
29 求。又本件聯電公司F32 DRAM CELL結構係業界常稱的 3乘2、
30 300T的結構。斯時開發DRAM CELL時，DRAM CELL國際間領先的
31 廠商為三星公司，故聯電公司有購買三星公司產品之逆向工程

01 報告，欲朝三星公司方向開發。當時美國美光公司25奈米DRAM
02 結構係2乘3，剛好與聯電公司相反。倘CELL的結構不同，會影
03 響週邊電路佈局，因300T即3乘2跟2乘3，為DRAM記憶體晶胞內
04 之字元線與位元線，3乘2跟2乘3分別為字元線跟位元線之最小
05 限寬，字元線與位元線大小不同，連帶外面週邊電路規則，即
06 佈局圖不同，設計規則亦大相逕庭等語（參見本院111年度刑
07 智上重更一字第1號卷八第386至391頁、第394至396頁），與
08 證人楊名聲所述情節殊無二致，俱徵證人楊名聲所述為真。

09 (3)佐以證人即前聯電公司員工呂文傑於本院審理時證稱：當時伊
10 係負責DRAM CELL記憶胞製程之研發，而 DRAM研發較困難之處
11 在記憶胞區，為製程微縮，聯電公司當時係靠逆向工程以三星
12 公司作為標的指標，至於週邊電路當時有兩間設計公司○○○
13 ○○○及晶豪科公司，負責週邊電路設計，聯電公司主要花費
14 人力、物力及時間在開發記憶胞區，再整合記憶胞區跟週邊
15 電路區。聯電公司F32 DRAM記憶胞區最小尺寸係25奈米，然
16 當時週邊電路區最小尺寸為65奈米，且聯電公司在2018年間製
17 程能力已可及於14奈米產品，對聯電公司而言，週邊電路區相
18 對記憶胞區較易開發，又F32 DRAM工藝的製程5、600道，週邊
19 電路僅80至100道，故本案人力、研發之重心均在記憶胞區。
20 至於本案聯電公司週邊電路之設計規則如何研發，因設計公司
21 ○○○○○及晶豪科公司有提供設計圖之GDS，故設計規則之
22 週邊電路即直接採用設計公司提供之電路佈局圖，再搭配聯電
23 公司自己之製程能力可及於14奈米產品，此為上開週邊電路設
24 計規則之由來。本件聯電公司研發記憶胞的結構與三星公司相
25 似，因三星公司與美國美光公司在那個世代的記憶胞架構係完
26 全不同，三星公司係3乘2，即字元線與位元線所佔寬度係每個
27 單位面積內有3個字元線跟2個位元線，而美國美光公司當時係
28 2個字元線、3個位元線，整個結構不同。而記憶胞結構不同
29 亦會影響週邊電路佈局之週邊電路設計規則，2乘3之字元線與
30 位元線之排列，與3乘2之字元線與位元線之排佈，週邊電路接
31 出之電路亦不同，如美國美光公司2乘3架構中，有一個位元線

01)，然此僅能證明戎樂天在搜索前曾警告或要求移除電腦內資
02 料，尚無法作為被告戎樂天有意圖在大陸地區使用而取得、使
03 用本件營業秘密之佐證。

04 6.又被告王永銘與友人謝奕偉間、被告王永銘與其妻曾玉蓮間LI
05 NE對話紀錄內容，雖顯示：

06 (1)被告王永銘與其友人謝亦偉(下稱nick)間之對話紀錄：

07 ①105年3月5日上午4時45分18秒至4時52分27秒：（擷取照片附
08 於106年度智訴字第11號卷十六第279頁）

09 nick：但你要去大陸他不用。

10 王永銘：對，去大陸是另外簽的。

11 nick：所以你要去嗎？

12 王永銘：他肯定會留在RnD。

13 nick：當然會。

14 王永銘：賺的比較快。

15 nick：幾倍、你老婆小孩怎辦？

16 王永銘：不知，那是一年後的事了。

17 ②105年2月27日下午2時3分33秒：（擷取照片附於106年度智訴
18 字第11號卷十六第281至283頁）

19 王永銘：跟UMCRnD做出自有技術。

20 nick：你意思是他在台灣搞rd技轉大陸就對了。

21 王永銘：心裡明白就好。

22 nick：這樣比較合理、幹那好多家要玩dram喔…、Dram又要
23 崩了。

24 王永銘：110S很慘，沒什麼效益。

25 nick：據說有可能掛掉。

26 王永銘：90S用以前賣ETT的模式在大陸搞，有前途、再者協
27 助UMC RnD搞出90S，以他以前的能力，100S就不是
28 問題。

29 nick：你說戎Sir嗎，他很久沒玩dram了。

30 ③105年4月3日上午4時3分17秒：（擷取照片附於106年度智訴字
31 第11號卷十六第285頁）

01 nick：所以你已經佔至高點可多看多學。

02 王永銘：是啦，我只是著眼run的出來，去大陸撈一票，退役
03 。

04 ④105年4月17日上午9時17分52秒：（擷取照片附於106年度智
05 訴字第11號卷十六第287頁）

06 王永銘：U那邊進度只要符合里程碑，年薪＋獎金估計可達3
07 00，到大陸建廠則更高、但就是擔心實力不夠。

08 ⑤105年11月28日下午12時43分55秒至12時44分17秒：（擷取照
09 片附於106年度智訴字第11號卷十六第295頁）

10 王永銘：打完這一仗，我想休息了。

11 nick：先離職嗎。

12 王永銘：大陸的啊、4年約。

13 (2)被告王永銘與其妻曾玉蓮105年12月23日上午11時53分23秒至
14 下午12時50分10秒之對話紀錄：（擷取照片附於 106年度智訴
15 字第11號卷十六第297頁）

16 王永銘：升M2了。

17 曾玉蓮：經理嗎？

18 王永銘：對，想不到我可以走到這個境界。

19 曾玉蓮：越上面壓力越大，有帶人嗎？

20 王永銘：10幾個、大S還要我們去大陸開戶，每年多給30萬人
21 民幣。

22 此有被告王永銘與友人謝奕偉間、被告王永銘與其妻曾玉蓮
23 間之對話擷取照片在卷足稽（參見106年度智訴字第11號卷十
24 六第279頁、第281至283頁、第285頁、第287頁、第295頁、
25 第297頁），然上開證據，僅能證明被告王永銘曾提及美國美
26 光公司、臺灣美光公司獨有產品編號110S、100S、90S及大陸
27 等詞之事實，尚無從證明被告王永銘有意圖在大陸地區使用
28 而使用、洩漏營業秘密及洩漏工商秘密犯行。

29 7. 準此，雖被告王永銘於本院審理時就起訴書所載全部犯行均
30 予以坦認，然起訴書所指其涉犯營業秘密法第13條之2之罪及
31 洩漏工商秘密罪，未據檢察官提出任何證據證明被告王永銘

有使用、洩漏本件美國美光公司之DRAM技術在本件F32奈米DRAM開發技術及意圖在大陸地區使用營業秘密等節，且卷內亦無其他跡證可資補強，故實難僅憑被告王永銘之單一自白，即遽認被告王永銘有意圖在大陸地區使用而使用、洩漏營業秘密及洩漏工商秘密之犯行及被告戎樂天有意圖在大陸地區使用而取得、使用營業秘密之犯行。

(四)背信部分(即被告王永銘部分)

1.按刑法第 342條之背信罪，以行為人為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益，為其構成要件。此處所謂「為他人處理事務」，係指行為人受該他人(即本人)委任，為他人處理事務，而形成照料義務。亦即刑法背信罪之主體，限於為他人處理事務之人，僅於行為人本於與他人之內部關係(例如委任、僱傭契約)所生義務，對外以他人之授權為本人處理事務，而立於為他人處理事務之地位時，始該當於背信罪之主體(最高法院 [112年度台上字第1944](#)號判決意旨參照)。換言之，背信罪所謂的為他人處理事務，應該限於為他人處理外部關係的財產上的法律事務(變動法律上權利義務關係之事務)，而所謂造成財產或其他利益的損害，也是專指外部關係(本人與第三人間)的(違背本人意思的)利益損失，並不及內部關係之機械性事務之違反。準此，若被告並無處理本人對外關係之財產上法律事務，或無損及本人與第三人間之利益輸送，僅係本人與行為人內部法律關係之違反，應為單純民事債務不履行範疇，核與刑法背信罪之不法構成要件無涉。復按刑法上背信罪所指為他人處理事務，在性質上應限於具有相當責任性之事務，而且行為人在處理上有權作成決定，或是行為人在處理上需要作成決定之事務(最高法院 [85年度台上字第660](#)號判決意旨參照)。而檢察官之起訴意旨固認被告王永銘涉有背信之犯行，然均未具體論及被告王永銘在本案係受告訴人臺灣美光公司委託處理何事務，而有如何違背任務之行為。

01 2.又被告王永銘於案發期間係在告訴人臺灣美光公司擔任品質
02 工程部副理，主要之業務內容為新機種之打樣、試做或協助
03 測試機種之改善，不屬受委任為他人對外處理財產事務之人
04 ，亦與告訴人對外財產事務之法律關係發生變動無涉。至有
05 關告訴人臺灣美光公司人員如需取得C電磁紀錄及D紙本資料
06 ，依告訴人臺灣美光公司之作業方式，區分「同部門」及「
07 跨部門合作」而有所不同。(1)同部門之人員，有存取檔案
08 資料之需求時，可向資訊部門要求提供協助，由資訊部門在
09 伺服器端開設空間並進行系統設定，設定之範圍與權限僅限
10 「上開提出需求之部門員工或獲授權之員工」在允許「存取
11 該空間(資料夾)內」之檔案資料。(2)跨部門合作時，如業
12 務有跨部門合作之需求，臺灣美光公司之資訊部門即將跨部
13 門合作之人員所需存取、共享的檔案，置於SharePoint平台
14 上，有獲得授權之跨部門合作之專案人員始可存取SharePo
15 int上之資料夾，由「專案負責人」或「SCA」（類似系統管
16 理員之角色）處理、篩選、調整該專案資料夾的權限設定，
17 准否取得平台上檔案。被告王永銘曾於臺灣美光公司擔任S
18 CA而被授權之範圍內，與專案負責人有相同權限，可決定檔
19 案之存取權限、分享範圍等。至被告王永銘在何專案曾任專
20 案負責人或 SCA，臺灣美光公司因檔案甚大尚難徹查等情，
21 此有臺灣美光公司函暨附件說明(參見本院111年度刑智上重
22 更一字第 1號卷九第143至163頁)在卷可佐，亦難認上開C電
23 磁紀錄及 D紙本資料為被告王永銘在告訴人臺灣美光公司依
24 其職務在工作上所得決定處理之事務。

25 3.是以，被告王永銘與告訴人臺灣美光公司所簽之保密暨智慧
26 財產合約固有保密責任條款，被告王永銘重製並使用上開C
27 電磁紀錄及 D紙本資料，雖可能違反與告訴人臺灣美光公司
28 間約定就公司資料之保密且不得重製、使用之不作為義務，
29 但究非刑法第342條第1項所定為他人處理事務之情形，被告
30 王永銘不具有刑法第342條第1項所定為他人處理事務之身

01 分。從而，被告王永銘前開被訴之行為，自不合於刑法所定
02 背信罪之身分要件，而難以該罪相繩。

03 五、基上所述，此部分依檢察官所指之證據，並未能使本院達於
04 被告何建廷、王永銘、戎樂天有何上揭被訴之意圖在大陸地
05 區使用營業秘密罪嫌之心證，被告王永銘有何上揭被訴之背
06 信、洩漏工商秘密罪嫌之心證，且本院復查無其他積極確切
07 之證據，足認被告何建廷、王永銘、戎樂天有何前開檢察官
08 所指之之意圖在大陸地區使用營業秘密或洩漏工商秘密、背
09 信犯行，此部分核屬不能證明被告何建廷、王永銘、戎樂天
10 犯罪，檢察官認被告何建廷、王永銘此部分與前開經起訴論
11 罪之使用營業秘密犯行有裁判上一罪關係，故就被告何建廷
12 、王永銘不另為無罪之諭知，被告戎樂天被訴意圖在大陸地
13 區使用而取得使用營業秘密部分為無罪之判決，以昭審慎。
14 原審未查，逕就此部分為實體判決，適用法則尚有未洽。被
15 告戎樂天據此上訴指摘原判決此部分不當，為有理由，自應
16 由本院將原判決此部分撤銷，改諭知被告戎樂天無罪、被告
17 何建廷及王永銘不另為無罪之諭知。

18 丙、公訴不受理部分(被告戎樂天被訴營業秘密法第13條之1之罪
19 部分)：

20 (一)公訴意旨略以：被告戎樂天明知被告王永銘已從臺灣美光公
21 司離職近半年，其所持有之臺灣美光公司資料應係以不正方
22 法所取得，竟意圖在大陸地區使用及損害美國美光公司之利
23 益，要求被告王永銘參考美國美光公司之資料（即DR25nmS
24 設計規則），與聯電公司F32 DRAM「設計規則」交互比對，
25 將不同部分挑出，標上美國美光公司之DRAM設計規則之穩定
26 數值，填寫包含無法以逆向工程回推之離子植入等相關必要
27 參數，協助完成設計規則中「Cell」、「Array」及「Peri
28 phery」等部分，再交給被告戎樂天審閱，以使聯電公司加
29 速完善F32 DRAM設計規則內容。因認被告戎樂天亦涉違反營
30 業秘密法第13條之1第 1項第4款之明知他人擅自重製取得持
31 有之營業秘密，而取得該等營業秘密罪嫌。

01 (二)按告訴乃論之罪，其告訴應自己為告訴之人知悉犯人之時起
02 於 6 個月內為之；又告訴或請求乃論之罪，未經告訴、請
03 求或其告訴、請求經撤回或已逾告訴期間，應諭知不受理之
04 判決，刑事訴訟法第237條第1項、第303條第3款定有明文。

05 (三)檢察官起訴書認被告戎樂天係觸犯營業秘密法第13條之1第1
06 項第4款之罪，依營業秘密法第13條之3第1項之規定，須告
07 訴乃論。然本案係告訴人臺灣美光公司、美國美光公司委由
08 告訴代理人對被告王永銘、聯電公司提出刑事告訴，此有10
09 5年8月25日刑事告訴狀、105年12月14日刑事告訴補充理由
10 (三)狀在卷可參(參見105年度他字第6099號卷一第5至15
11 頁、第281至287頁)，告訴人復於106年 2月13日委請王仁君
12 律師於偵訊時表明對被告何建廷提出違反營業秘密法等案件
13 之告訴等語明確，亦有王仁君律師106年 2月13日偵訊筆錄1
14 份(參見105年度他字第6099號卷二第187頁)在卷可佐，此外
15 遍觀全卷，未見有告訴權人即臺灣美光公司、美國美光公
16 司對被告戎樂天提出此部分告訴，自難謂被告戎樂天所涉違
17 反營業秘密法第13條之 1之罪部分已經合法告訴。

18 (四)復按起訴為裁判上一罪之案件，倘法院審理結果，認為一部
19 不成立犯罪，他部又欠缺追訴要件，則一部既不成立犯罪，
20 即難與他部發生一部及全部之關係，法院應分別為無罪及不
21 受理之諭知(最高法院70年台非字第11號判例參照)。公訴意
22 旨就被告戎樂天被訴違反營業秘密法第13條之 1之罪、同法
23 第13條之 2之罪部分，雖認其間具有裁判上一罪關係，然被
24 告戎樂天被訴違反營業秘密法第13條之 2之罪部分，既經本
25 院為無罪之判決，已如前述，揆之前揭說明，自應就被告戎
26 樂天被訴違反營業秘密法第13條之 1之罪部分，另為公訴不
27 受理之諭知。原審不查，逕就此部分為實體判決，適用法則
28 尚有未洽。被告戎樂天據此上訴指摘原判決此部分不當，為
29 有理由，自應由本院將原判決此部分撤銷，改諭知公訴不受
30 理。

31 據上論斷，依刑事訴訟法第369條第1項前段、第364條、第299條

01 第1項前段、第301條第1項前段、第303條第3款，判決如主文。

02 本案經檢察官陳立偉提起公訴，檢察官張添興提起上訴，檢察官
03 羅雪梅、劉怡君、鄒茂瑜到庭執行職務。

04 中 華 民 國 115 年 2 月 13 日

05 智慧財產第四庭

06 審判長法 官 蔡慧雯

07 法 官 彭凱璐

08 法 官 李郁屏

09 以上正本證明與原本無異。

10 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未
11 敘述上訴理由者，並得於提起上訴後20日內向本院補提理由書（
12 均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。

13 中 華 民 國 115 年 2 月 26 日

14 書記官 劉亭筠

15 附錄論罪科刑法條全文：

16 營業秘密法第13條之1

17 意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利
18 益，而有下列情形之一，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新
19 臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金：

20 一、以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取
21 得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。

22 二、知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使
23 用或洩漏該營業秘密者。

24 三、持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不
25 為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。

26 四、明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取
27 得、使用或洩漏者。

28 前項之未遂犯罰之。

29 科罰金時，如犯罪行為人所得之利益超過罰金最多額，得於所得
30 利益之三倍範圍內酌量加重。

01 附表一：
02

編號	犯罪事實	罪名、宣告刑及沒收
1	犯罪事實欄二	何建廷犯營業秘密法第十三條之一第一項第二款之持有營業秘密，逾越授權範圍而使用營業秘密罪，處有期徒刑拾月。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供100小時之義務勞務。 扣案如附表三編號25、34、35、36、38所示之物均沒收。
2	犯罪事實欄三	王永銘犯營業秘密法第十三條之一第一項第一款之擅自重製營業秘密後進而使用營業秘密罪，處有期徒刑陸月，如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。緩刑貳年，緩刑期間付保護管束，並應向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體提供80小時之義務勞務。 扣案如附表三編號2、3、5、6、9、16、20、22、24、38所示之物均沒收。

03 附表二：王永銘使用之儲存裝置
04

編號	儲存裝置	附件內容
1	附表三編號2所示筆記型電腦	附件二(一)編號1至9、473、861、1063、1065至1067
2	附表三編號6所示筆記型電腦	附件二(一)編號1、10至412、417、419、427、434、469、47

		3、477、480、482、485、769至773、785、789至790、794、798至801、803至807、810至816、819至828、830、832至853、855至880、889、934、939、1002至1006、1059、1070、1075至1081
3	網路雲端硬碟	附件二(一)編號2至11、13至19、25、67、153、176、198、242、249至250、253至294、318、330、336、338至358、381至389、392、394至410、412至469、474至524、526、543、644至646、648、650至651、653至656、658至661、678、690、692至703、705、719、722、724、726、769至808、817至818、828至829、834、836至841、846至847、854、858至860、881至894、938至939、946至947、951至960、963至999、1002至1073、1077、1080
4	附表三編號16所示行動電話	附件二(一)編號417至419、473、803、860、934至935、939、1065、1070、1074、1077
5	附表三編號19所示筆記型電腦	附件二(一)編號15、414、469至473、1072至1073
6	附表三編號5所示隨身硬碟	附件二(一)編號474至767

7	附表三編號20所示隨身碟	附件二(一)編號2、417、419、434、469、473、515至516、519、526至528、530至532、534至535、537至538、540至541、543、574、587、590、594至595、601、607、613至615、626至628、639至640、642至646、648至651、653至656、658至661、678、690、692至705、719、722、724、726至727、731至739、741、768至1060、1075至1080
---	--------------	--

附表三：扣案物

編號	扣案物品名稱	數量	所有人	扣案地點	備註
1	王永銘使用之HP筆記型電腦(贓物庫編號1)	1台	臺灣 美光公司	新北市調查處	起訴書附表一
2	COMPAQ筆記型電腦(含電源線)(贓物庫編號2)	1台	王永銘	○○市○○區○○巷00號	起訴書附表二
3	Rundish隨身碟(贓物庫編號3)	1支		○○市○○區○○路0段000號00樓之9	起訴書附表三
4	隨身硬碟	1個			
5	ViPower隨身硬碟(贓物庫編號5)	1個			
6	Acer筆記型電腦(含電源線)(贓物庫編號6)	1台			
7	聘僱契約書	1本			
8	王永銘之永豐銀行新竹分行存摺	1本			
9	王永銘文件資料(C-1-1、C-1-2、C-1-	3本		○○市○○區○○路428、43	起訴書附表四

	3) (贓物庫編號9)			30號1至9樓	
10	白色之隨身碟	1個			
11	PM2組織表	1張			
12	王永銘文件資料 (A-2-1、A-2-2、A-2-3)	3本			
13	UMC人事資料表	1本			
14	王永銘筆記本	1本			
15	手寫札記	1本			
16	ASUS行動電話(含門號091184291 號SIM卡1枚) (贓物庫編號16)	1支			
17	ITREE行動電話 (含門號0965702303 號SIM卡1枚)	1支			
18	Sandisk隨身碟	1支			
19	黑色ASUS筆記型電腦(含電源線) (贓物庫編號18)	1台	聯電公司		
20	銀色隨身碟(PNY128GB) (贓物庫編號20)	1支	王永銘	臺灣臺中地方檢察署開庭時提出	起訴書附表六
21	紙本資料	1本			
22	紙本資料(贓物庫編號22)	1本			
23	筆記本	1本			
24	黑色隨身碟 (64GB)	1支	法務部調查局	新北市調查處106年2月14日詢問王永銘時，從王永銘Google帳號即雲端硬碟下載所得資料	起訴書附表十一
25	行動硬碟(贓物庫編號25)	1個	何建廷	臺灣臺中地方檢察署開庭後，被	起訴書附表七

				告何建廷主動提出扣押	
26	筆記本	4本		○○市○○區○○路00號之被告何建廷聯電公司辦公室	起訴書附表八
27	美光公司函文	1本			
28	勞動合約	1本			
29	ASUS行動電話(含門號0910411131號、0965280938號SIM卡各1枚)	1支			
30	雜記	1張			
31	ASUS筆記型電腦(含電源線)	1台			
32	聯電資料	2張			
33	電子郵件隨身碟	1個			
34	紙本資料(編號2至8、10至15)(贓物庫編號35)	13本		臺灣臺中地方檢察署第三偵查庭開庭時提出	起訴書附表六
35	Kingston廠牌之隨身碟(贓物庫編號36)	1個			
36	爾必達、瑞晶后里技術研發中心營運計畫書(贓物庫編號37)	1本			
37	HP筆記型電腦(聯電標籤UMC030761)(贓物庫編號34)	1台	聯電公司		
38	黑色隨身碟(1TB)(贓物庫編號48)	1個	法務部調查局	鑑驗後，另儲存A電磁紀錄及C電磁紀錄	起訴書附表十一